

รายงานการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบคิวสวิตท์เลเซอร์ (Research and Development of Q-switched Laser System)

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ
ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ พันธุ์มานะวิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตองนิกส์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีงบประมาณ พ.ศ. 2538
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว
กันยายน 2543

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ดำเนินการวิจัยของบุคคลเป็นอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้เลี้ยง
เห็นความสำคัญให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดย
ได้มอบทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้วิจัย ประจำปี พ.ศ. 2538/39 จนทำให้การวิจัยสำเร็จลงด้วยดี

ผู้วิจัยของบุคคล สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีและฟotonิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่ได้ให้การสนับสนุนงานนี้สำเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยของบุคคลไว้ว ณ ที่นี่เป็น
อย่างยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ พันธุ์มานะวิน)

หัวหน้าโครงการวิจัย

กันยายน 2543

บทคัดย่อ

ระบบคิวสวิตท์เลเซอร์ที่ใช้แท่งพลีก ND:YAG ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง $\varnothing = 6$ มม. และยาว 75 มม. เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับเป็นครั้งแรก หัวเลเซอร์ทำด้วยทองเหลือง ผิวในชุดด้วยทอง โดยมีลักษณะของผิวสะท้อนแสงของหัวเลเซอร์เป็นแบบ Closed coupling แท่งพลีก Nd:YAG และหลอดแฟลชแอลมพ์ วางบนสามเหลี่ยม กะรากปิดหัวท้ายเลเซอร์คาวิตี้ประกอบด้วยกระบอก M_1 มีค่าสะท้อนแสงกลับ $R_1 = 100\%$ และกระบอก M_2 มีค่าสะท้อนแสงกลับ $R_2 = 80\%$ รักมีความโถ้งของ M_1 และ M_2 เป็น $r_1 = r_2 = 5000$ มม. ระยะทางระหว่าง M_1 และ M_2 มีค่าเท่ากัน 340 มม. ได้มีการสร้างเครื่องจ่ายกำลังที่ให้กระแสไฟตรง 0-20 มิลลิแอมป์ และศักดิ์ 0-3000 โวลต์ เพื่อจ่ายกำลังให้กับหลอดแฟลชแอลมพ์ แสงเลเซอร์ที่ได้เป็นแบบคิวสวิตท์ พักส์ มีไฟลาไรเซชั่นเป็นแบบเรนคอม และมีพลังงานสูงสุดเท่ากับ 768 มิลลิจูล (mJ) ซึ่งได้ผลเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างดี

Abstract

A Nd:YAG laser system operated in Q-switched pulse was designed and developed. The ~~laser~~ head had a closed coupling type cavity in which the Nd:YAG rod of diameter $\emptyset = 6$ mm with length of 75 mm was in parallel to a linear flashlamp. The surface of the laser head cavity was gold coated for better reflection. The laser cavity was formed by end mirrors of M_1 and M_2 with reflectivities $R_1 = 100\%$ and $R_2 = 80\%$ at wavelength $\lambda = 1064$ nm, respectively. Radii of curvature of both mirrors were $r_1 = r_2 = 5000$ mm. The separation of M_1 and M_2 was 340 mm. A power supply was developed and supplied d.c. current of 0-20 mA and voltage of 0-3000 volts for flashlamp. The maximum laser energy output was measured to be 768 mJ with random polarization. The results were in agreement as planned.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.2 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
บทที่ 2. ทฤษฎี.....	4
2.1 หลักการเบื้องต้นของเดเซอร์.....	4
2.1.1 วัสดุที่เป็นแหล่งกำเนิดเดเซอร์.....	5
2.1.2 Einstein Relation.....	7
2.1.3 เดเซอร์พัมพิ่ง.....	10
2.1.4 ออฟติคอลเรโซแนเตอร์.....	13
2.2 ระบบโนไดเมี่ยมเย็บเดเซอร์.....	16
2.3 คิวสวิตท์เดเซอร์พัลส์.....	18
2.3.1 หลักการและวิธีการผลิตคิวสวิตท์เดเซอร์พัลส์.....	18
2.3.2 อิเล็กโทรอฟติคชัทเตอร์.....	19
บทที่ 3 การสร้างระบบเดเซอร์.....	22
3.1 การออกแบบหัวเซอร์.....	22
3.2 การออกแบบระบบนำเข้ากำลัง.....	25
3.3 แห่งพลิกโนไดเมี่ยมเย็บ.....	28
3.4 การจัดวางกระชากเดเซอร์.....	28
บทที่ 4 การทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล.....	30
4.1 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	30
4.1.1 กระจกเคลือบพิเศษ.....	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.1.2 เครื่องวัดพลังงาน (Energy meter)	30
4.1.3 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) และเครื่องถ่ายภาพ โพลารอยด์	31
4.1.4 โฟโตไดโอด (Photodiode)	31
4.2 การจัดระบบคิวติท์เดเซอร์.....	31
4.3 การวัดกำลังของแสงเดเซอร์ที่ออกมा.....	32
4.4 การวัดスペกตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์.....	34
4.5 รอยเผาไหม้ (Burnt Pattern) ของแสงเดเซอร์.....	35
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและพัฒนา.....	38
บรรณานุกรม	39
ภาคผนวก	41
ภาคผนวก ก	42
ภาคผนวก ข	43
ประวัติผู้เขียน	44

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

1. ข้อมูลการวัดค่าพลังงานของเดเซอร์ 42

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 ค่าระดับพลังงานของอะตอม.....	5
2.2 แสดงการเปลี่ยนค่าระดับพลังงาน (Atomic transition) ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอะตอม	6
2.3 แสดงถึงการเพิ่ม/ลดของความเข้มของแสงเมื่อผ่านเนื้อสาร.....	9
2.4 แสดงจำนวนอะตอมที่มีค่าระดับพลังงาน E_i, E_j	11
2.5 แสดงหลักการเกิดเลเซอร์แบบสามระดับและแบบสี่ระดับ (Three Level and Four Level Lasers)	12
2.6 แสดงการจัดระบบเดเซอร์ที่ประกอบด้วยเดเซอร์มีดีไซม์และเรโซโนเตอร์คาวิตี้.....	13
2.7 แสดงการจัดเรโซโนเตอร์คาวิตี้.....	15
2.8 แสดงการจัดวางเรโซโนเตอร์คาวิตี้แบบต่าง ๆ	16
2.9 แสดงระดับพลังงานของ Nd:YAG และการเกิดแสงเลเซอร์จากการเปลี่ยน ระดับพลังงาน $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$	17
2.10 แสดงสปอนเทเนียลส้อมีชั้นเสปคตรัมของ Nd:YAG บริเวณย่านไกล์คี Ying $\lambda = 1.064 \mu m$	17
2.11 แสดงการใช้วิธีอิเล็กโทรอฟติก (Electrooptics) จากพอกคอลเซลล์ (Pockel cell) เพื่อการเกิดคิวสวิต์เลเซอร์พัลซ์	21
3.1 แสดงการจัดวางระบบ Nd:YAG เลเซอร์ พร้อมเครื่องจ่ายกำลัง	23
3.2 แสดงรูปแบบของเลเซอร์คาวิตี้และตำแหน่งที่จะใส่แฟลชแอลมพ์และแท่น พลิกนิโอดิเมี่ยน	24
3.3 แสดงแสดงวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของระบบจ่ายกำลัง (Power supply)	26
3.4 แสดงการจ่ายกระแสไฟตรงจากตัวเก็บประจุ (Capacitor) ไปยังแฟลชแอลมพ์ เป็นไปแบบ Critical damp discharge	27
3.5 แสดงขนาดและการวางตัวของพดลึกในแท่นนิโอดิเมี่ยมแยก.....	28
3.6 แสดงข้อความกราฟิก M_1 และ M_2 ของออฟทิคอลเรโซโนเตอร์ $L = 340$ มิลลิเมตร	29
4.1 แสดงการจัดวางระบบคิวสวิต์เลเซอร์โดยมี Pockel cell.....	31

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2 แสดงการจัดวางเครื่องมือในการวัดพลังงาน (Energy) ของระบบเลเซอร์ที่ออกแบบแก่หลัก Nd:YAG.....	32
4.3 ความสัมพันธ์ของกำลังเลเซอร์ (Laser power output) กับศักดิ์ไฟฟ้าของเครื่องจ่ายกำลัง	33
4.4 แสดงการจัดวางเครื่องมือเพื่อการจัดเสปคตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์.....	34
4.5 แสดงเสปคตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์.....	35
4.6 แสดงการจัดวางเครื่องมือเพื่อการถ่ายภาพ Laser Spikes และการถ่ายเผาไหม้ (Burnt Pattern)	36
4.7 แสดงรอยเผาไหม้ (Burnt Pattern) ของแสงเลเซอร์บนโพลารอยด์ฟิล์ม.....	36

บทที่ 1

บทนำ

แสงเลเซอร์ (LASER) เป็นลำแสงที่ได้มาจากการหางฟิสิกส์ที่มีชื่อว่า Light Amplification by Stimulated Emission Radiation ตัวแสงเลเซอร์ได้ถูกผลิตออกมารูปแบบครั้งแรกจากรูปนีโอเลเซอร์ (Ruby Laser) โดย Maiman (1960) ในห้องปฏิบัติการ Hughes Research Laboratories ต่อมาได้มีการพัฒนาและค้นพบเลเซอร์แบบต่าง ๆ อีกมากนanya จนกระทั่งในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตระบบ X-ray Laser (Robinson; 1984) ซึ่งมีศักยภาพสูงในการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติความเป็นมาในการพัฒนาและก่อให้เกิดการค้นพบแสงเลเซอร์นั้นย้อนหลังไปได้ประมาณ 83 ปีกล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1917 Einstein ได้พนทฤษฎีของ Stimulated emission ในอะตอม ทฤษฎีของ Einstein นี้ต่อมาเป็นฐานสำคัญในการทำให้เกิด stimulated emission ในวัสดุและทำให้เกิดแสงเลเซอร์ขึ้น ในระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-1940 ได้มีการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุลมาก จนทำให้นักฟิสิกส์ทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับค่าระดับพลังงาน (Energy level) ของอะตอมและโมเลกุลมากพอที่จะสามารถนำมาใช้ทำให้เกิดเลเซอร์ได้ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1939-1945 ซึ่งเป็นระยะช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สอง นักวิทยาศาสตร์ได้ทุ่มความสนใจไปในด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear physics) และไมโครเวฟ (Microwave-radar) อย่างมากทำให้การพัฒนาเกี่ยวกับหางค้านแสงลดน้อยลง ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการค้นพบเมเซอร์ (MASER-Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation) โดย J. P. Gordon et. al. (1954) เมเซอร์ทำงานโดยหลักการของ Stimulated emission โดยผลิตคลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้าที่ช่วงความยาวคลื่น λ ในระดับไมโครเวฟ ต่อมา Schalow และ Towners (1958) ได้เสนอแนะแนวความคิดว่า หลักการทำงานของเมเซอร์ (Maser) นั้นสามารถดัดแปลงและทำให้เกิดคลื่น λ ในระดับที่ตามองเห็นได้ โดยเรียกขบวนการนี้ว่า “Optical maser” โดยการนำหางความคิดของ Schalow และ Towners ประกอบกับการเสนอแนะแนวทางใหม่ของระบบเมเซอร์ โดย Bloembergen (1956) Miman (1960) แห่งห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัท Hugh แหนร์รูอเมริกา ได้สามารถผลิตลำแสงเลเซอร์จากรูปนีโอเลเซอร์ (Ruby

Laser) ได้สำาเร็จเป็นครั้งแรก รูปีเลเซอร์ของ Maiman นั้นเป็นแบบ Solid state laser ได้ผลิตเลเซอร์สีชมพูที่ความยาวคลื่น 694.3 nm และเลเซอร์ชนิดนี้ยังใช้สำางานตลอดมาถึงปัจจุบัน

ระบบโนดิเมียมแอกเลเซอร์ (Nd:YAG Laser) มีชื่อเต็มทางวิทยาศาสตร์คือ โนดิเมียมยตเตรีมอะลูมินัมการ์เนท (Neodymium Yttrium Aluminum Garnet) กล่าวคือ ธาตุ Nd เป็นส่วนที่เป็นอิมพิริตแฟรงตัวอยู่ในแท่ง Yttrium Aluminum Garnet ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$) Geusic และคณะ (1964) ได้ประสบผลสำาเร็จเป็นครั้งแรกที่ใช้แท่ง Nd:YAG เป็นสารเลเซอร์ (Laser medium) ทำให้เกิดแสงเลเซอร์ที่ช่วงคลื่น $\lambda = 1064\text{ nm}$ แสงเลเซอร์นี้เกิดจากประชาระผกผันของอะตอนนิโนดิเมียม โดยการกระตุ้นของแสงความเข้มสูงจากแฟลชแลมพ์ที่บรรจุแกสเซ็นอน (Xenon flashlamp) ที่อุณหภูมิของห้องทดลอง ($T \approx 300^\circ\text{ K}$)

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา

เนื่องจากบทบาทของ Nd:YAG Laser ได้มีอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม โดย Nd:YAG Laser ถูกนำไปใช้ในการตัด, เจาะ, เชื่อม และแอนนิลลิ่ง (Annealing) โลหะและวัสดุต่างๆ ในวงการแพทย์ก็ใช้เลเซอร์ระบบนี้ในการผ่าตัดนัยตาและอวัยวะภายในช่องท้อง ตลอดจนทางด้านการทหารก็นำเลเซอร์ระบบนี้ไปใช้ในการวัดระยะทาง (Range finder) การส่องชี้เป้า (Target illumination) และการนำวิธีของจรวดแบบเลเซอร์บอมบ์ (Laser bomb)

ผู้วิจัยจึงตระหนักในความสำคัญและต้องการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีของเลเซอร์ระบบนี้ให้เข้าใจดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ

1. เพื่อการพัฒนาและสร้างระบบ Nd:YAG เลเซอร์ โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อการศึกษาระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบหัศนศาสตร์ของเลเซอร์นี้ซึ่งเป็นความลับไม่สามารถรายละเอียดได้ในวารสารหรือต่างจากต่างประเทศ โดยเป็นระบบคิวสวิทช์เลเซอร์ ให้พลังงานประมาณ 500 mJ

2. เพื่อศึกษาหาข้อมูลทางเทคนิคและประสบการณ์ซึ่งจะใช้เป็นการสร้างตัวตนแบบต่อไป

3. ศึกษาขั้นการผลิตแสงเลเซอร์ระบบนี้ให้เข้าใจลึกซึ้งและนำ มา ประยุกต์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี เลเซอร์ต่อไป

1.2 ขอบเขตของการวิจัยและพัฒนา

ในการวิจัยและพัฒนานี้ กระทำในลักษณะของการออกแบบสร้าง ระบบเลเซอร์ โดยจะให้แสงเลเซอร์ที่กำลังปานกลางประมาณ 600 mJ แต่เป็น ระบบที่ให้แสงเป็นช่วงๆ ซึ่งเรียกว่าพัลส์ (Pulse) ที่มี Peak power สูง เหมาะแก่การนำไปใช้งานทั่วไป ระบบเลเซอร์จะถูกสร้างพร้อมกับระบบ เครื่องจ่ายกำลัง (Power supply) คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ซึ่งจะมีพารา มิเตอร์ต่างๆ จะถูกวัดตามขีดความสามารถของเครื่องมือที่มีอยู่'

บทที่ 2

ทฤษฎี

ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบนิโอดิเมียมแม่กเลเซอร์นี้ จำเป็นต้องรู้ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบเลเซอร์ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced technology) ดังนั้นในบทนี้ภาคทฤษฎี จึงแบ่งเป็นทฤษฎีและหลักการของเลเซอร์ ซึ่งมีหลักการใหญ่ที่จำเป็นที่สุดคือเรื่อง ประชากรผกผัน (Population inversion) ภายในเนื้อสารเลเซอร์ (Medium) นอกจากนี้ จะได้มีการแสดงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะของระบบ Nd:YAG เลเซอร์ ซึ่งจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าพลังงานของธาตุ นิโอดิเมียม (Nd) อะตอม (Atomic transition) หลักการจัดออกฟิติกอลลาวิตี (Optical cavity) และเทคนิคต่างๆ

2.1 หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์ (Basic Principle of Lasers)

ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่าเลเซอร์มีหลายชนิด แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแยกออกเป็น Solid State Lasers, Gas Lasers และ Liquid Lasers (Dye Lasers, Chemical Lasers) โดยที่หลักการของเลเซอร์แบบต่างๆ นั้นอาศัย Amplified Stimulated Emission เป็นสำคัญ (Einstein, 1917; Yariv, 1989) อย่างไรก็ตามจะมีเลเซอร์บางชนิด (Nitrogen Laser, Free Electron Laser และ X-ray Laser) ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตเลเซอร์แตกต่างออกไป เลเซอร์เหล่านี้อาศัยหลักการ Amplified Spontaneous Emission ซึ่งผู้เขียนจะขอไม่กล่าวไว้ ณ ที่นี่ โดยจะเน้นที่ใช้ได้กับเลเซอร์ทั่วๆ ไป

องค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะทำให้เกิดแสงเลเซอร์นั้นสามารถแยกออกได้เป็น 3 องค์ประกอบคือ

ก. วัสดุที่จะให้เกิด Amplified Stimulated Emission ในกรณีโดยมากเราเรียกวัสดุนั้นว่า Active medium หรือสารเลเซอร์ (Laser medium)

ข. ขั้นตอนการที่ทำให้เกิด Population inversion ในเนื้อของ Active medium ขั้นการนี้เรียกว่า Pumping

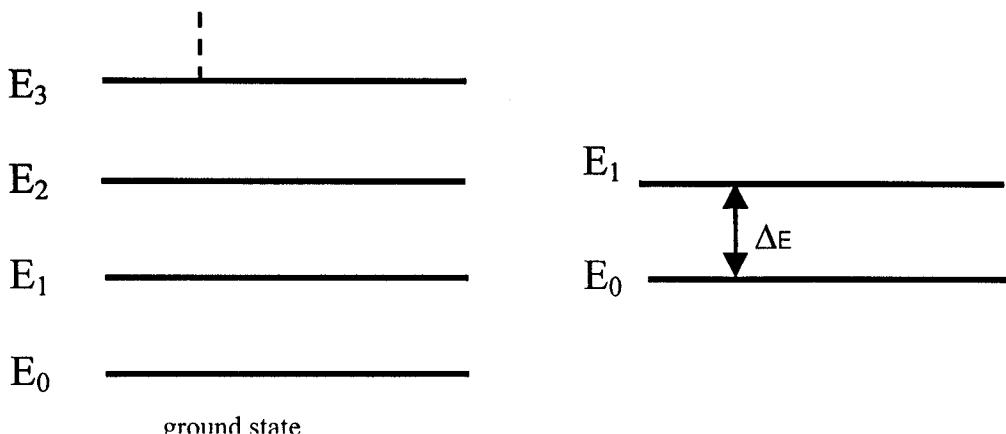
ค. ขั้นการที่จะทำให้เกิด Laser oscillation จนสามารถปลดปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาน้ำได้ ขั้นการนี้จะเป็นต้องมีการป้อนกลับ (Feed back) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะก่อให้เกิดมีการขยายเพิ่ม (Amplification)

ความเข้มของ Stimulated emission จนสามารถทำให้เกิดการปลดปล่อยแสง เลเซอร์ได้ ขบวนการนี้เกี่ยวกับ Resonator หรือ Optical cavity

ขบวนการเหล่านี้มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้คือ

2.1.1 วัสดุที่จะใช้เป็นที่กันเนิดแสงเลเซอร์ (Active medium)

เมื่อพิจารณาค่าระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในธาตุ สารประกอบต่างๆ แล้วจะพบว่าค่าระดับพลังงาน (Energy level) ของอิเล็กตรอน ธาตุ และสารประกอบต่างๆ แบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามแผนภาพ (รูปที่ 2.1)



รูปที่ 2.1 ค่าระดับพลังงานของอะตอม

ความถี่ (ν) ของโฟตอน (Photon) ที่จะถูกปลดปล่อยหรือดูดกลืนเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงระดับของพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นไปตาม ทฤษฎีของ Neil Bohr ตามสมการที่ (2.1)

$$\Delta E = E_1 - E_2 = h\nu \quad (2.1)$$

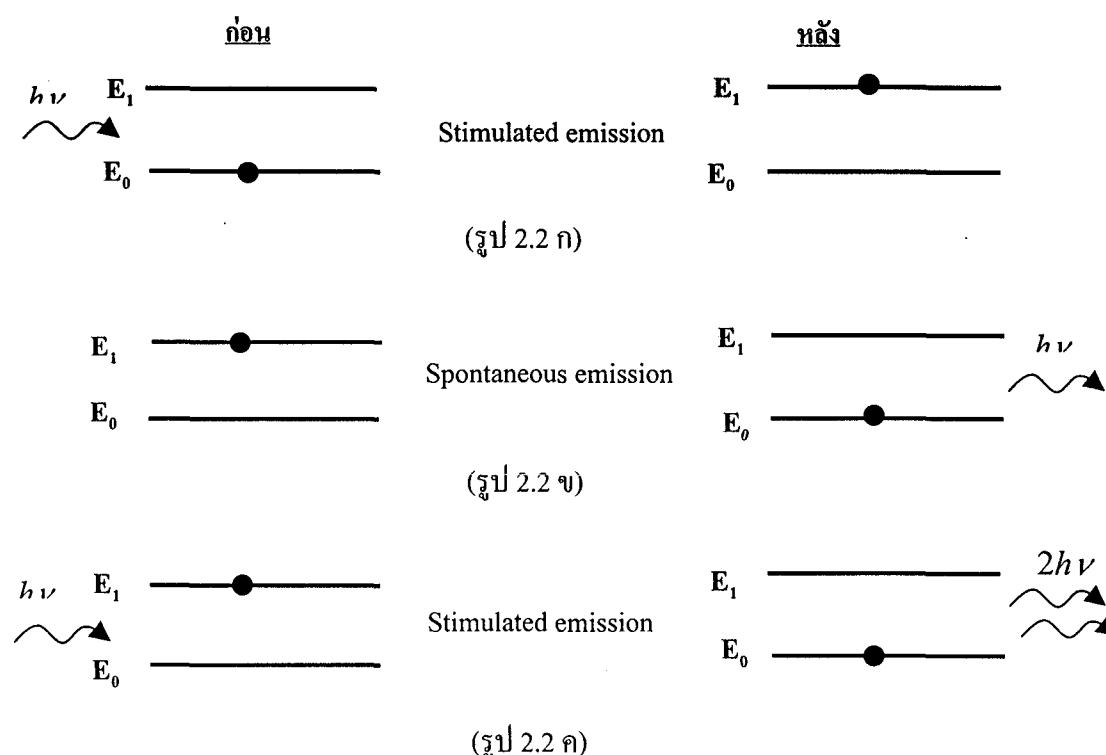
$$h = \text{Planck's constant} = 6.625 \times 10^{-34} \text{ Joule-sec}$$

ν =ความถี่ของโฟตอนที่จะถูกดูดกลืน/ปลดปล่อยจากการเปลี่ยนสภาพ ระดับพลังงานหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง

ในการเปลี่ยนค่าระดับพลังงาน(Energy level) ของอิเล็กตรอนใน อะตอมนั้นย่อมมีการปลดปล่อยโฟตอน (Photon) หรือดูดกลืนโฟตอน ทั้งนี้

จะต้องเป็นไปตามหลักการของ Selection rule ใน Quantum Mechanics ใน การดูดกลืน (Absorption) และปลดปล่อย (Emission) ของโฟตอน ภายใต้ อะตอมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการคือ

กระบวนการดูดกลืนโฟตอน (Stimulated absorption) กระบวนการนี้ อะตอมถูกกระตุ้น (Stimulated) โดยมีโฟตอนจากภายนอกมาทำให้อะตอม เปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับต่ำ E_0 (Ground state) ไปสู่ระดับสูงขึ้น E_1 (Excited state) โดยขบวนการนี้อะตอมจะดูดกลืนโฟตอนที่มีค่าความถี่ตาม สมการ (2.1) เข้าไว้ (ดูในรูป 2.2)



รูปที่ 2.2 แสดงการเปลี่ยนค่าระดับพลังงาน(Atomic transition) ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอะตอม

กระบวนการปลดปล่อยโฟตอนแบบ Spontaneous emission กระบวนการนี้เมื่ออัตโนมัติกะร่างกายในระดับพลังงานที่สูง E_1 (Excited state) อัตโนมัติที่อยู่ในระดับพลังงานนั้นได้ในนาน (ประมาณ 10^{-8} - 10^{-10} วินาที) ก็จะปลดปล่อยโฟตอนออกมานะ (Relaxation) และค่าระดับพลังงานจะลดลง ทำ

ให้อะตอมกลับมาอยู่ในระดับต่ำกว่าเดิม E_0 ในกรณีการปลดปล่อยโฟตอน เป็นไปโดยอิสระ (Spontaneous) ไม่ต้องมีการกระตุ้นให้มีการปลดปล่อยโฟตอนแต่อย่างใด (รูป 2.2)

กระบวนการปลดปล่อยโฟตอนแบบ Stimulated emission กระบวนการนี้อะตอมในตอนเริ่มแรกจะอยู่ในระดับพลังงานสูง E_1 และจะปลดปล่อยโฟตอนออกมานา (Emission) จนสุดท้ายค่าระดับพลังงานของอะตอมจะเป็น E_0 หากแต่ที่การปลดปล่อยโฟตอนในกระบวนการนี้จะเป็นต้องมีโฟตอนจากภายนอก (Stimulating photon) ที่มีความถี่ v ตามสมการที่ (2.1) มากระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อย โดยกระบวนการนี้จะมีโฟตอนออกมาน 2 ตัว ตัวแรกคือโฟตอนที่ไปกระตุ้น และอีกตัวหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลง (Transition) ของอะตอมจาก $E_1 \rightarrow E_0$ เป็นที่น่าสังเกตว่าโฟตอน 2 ตัวนี้มีความถี่เท่ากัน (พลังงานเท่ากัน) และ in phase กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะก่อให้เกิด Laser action ขึ้นในเมื่อสุดท้ายมีการเกิดเช่นนี้พร้อมกันในหลายๆ อะตอม ล้ำแสงเลเซอร์ที่จะเกิดขึ้นและมีความเข้ม (Intensity) สูง (รูป 2.2)

2.1.2 Einstein Relation

กระบวนการ Stimulated absorption, Spontaneous emission และโดยเฉพาะ Stimulated emission นั้น Albert Einstein ได้ตั้งทฤษฎีไว้เมื่อปี ค.ศ. 1917 ในกรณี Einstein ได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ (Coefficients) ไว้คือ

$$\begin{aligned} A_{10} &= \text{Einstein coefficient of spontaneous emission} \\ &= \frac{1}{\tau_{10}}; \tau_{10} \text{ transition life time of excited state } E_1 \end{aligned}$$

$$B_{01} = \text{Einstein coefficient of stimulated absorption}$$

$$B_{10} = \text{Einstein coefficient of stimulated emission}$$

สมมติว่าเรามีจำนวน N_1 อะตอมที่อยู่ในพลังงานระดับ E_1 เราจะพบว่าจำนวนอะตอม/วินาทีที่เปลี่ยนสภาพจากพลังงาน $E_1 \rightarrow E_0$ โดยกระบวนการ Spontaneous emission สามารถเขียนออกมายได้เป็น

$$\text{อัตราการเกิดของ Spontaneous emission} = N_1 A_{10} \quad (2.2)$$

อัตราการเปลี่ยนแปลงในสมการ (2.2) นั้นขึ้นอยู่กับ Einstein Coefficient A_{10} ชนิดของอะตอมและการเปลี่ยนค่าระดับพลังงานหนึ่งไปสู่อีกค่าระดับพลังงานหนึ่ง

สำหรับการเปลี่ยนค่าระดับพลังงานแบบ Stimulated absorption และแบบ Stimulated emission นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโฟตอนมากกระตุ้น (ซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบของ Radiation energy density ρ_ν) และโฟตอนที่มากระตุ้นนั้นจะเป็นต้องมีความถี่เป็น ν_{10} ซึ่งเป็นไปตามสมการ (2.1) สำหรับที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transition) จากระดับ $E_1 \rightarrow E_0$ หรือจาก $E_0 \rightarrow E_1$ ดังนี้

$$\text{อัตราการเกิดของ Spontaneous absorption} = N_0 \rho_\nu B_{01} \quad (2.3)$$

ซึ่ง B_{01} เป็น Einstein's coefficient of stimulated absorption และ N_0 เป็นจำนวนอะตอมที่ระดับพลังงาน E_0

$$\text{อัตราการเกิดของ Stimulated emission} = N_1 \rho_\nu B_{10} \quad (2.4)$$

เมื่อ B_{10} เป็น Einstein's coefficient of stimulated emission และ N_1 เป็นจำนวนอะตอมที่ระดับพลังงาน E_1

$$\text{เราทราบว่า Radiation energy density } \rho_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi c} \quad (2.5)$$

เมื่อ I_ν เป็นความเข้มของแสงที่ความถี่ ν

c เป็นความเร็วของแสงในสูญญากาศ

ดังนั้นแทนค่า ρ_ν ของสมการ (2.5) ในสมการ (2.3) และ (2.4) เราจะได้

$$\text{อัตราการเกิด Stimulated absorption} = N_0 \frac{I_\nu}{4\pi c} B_{01} \quad (2.6)$$

$$\text{อัตราการเกิด Stimulated emission} = N_1 \frac{I_\nu}{4\pi c} B_{10} \quad (2.7)$$

เมื่อคิดกรีปกติที่มี Thermal equilibrium แบบ Black body radiation

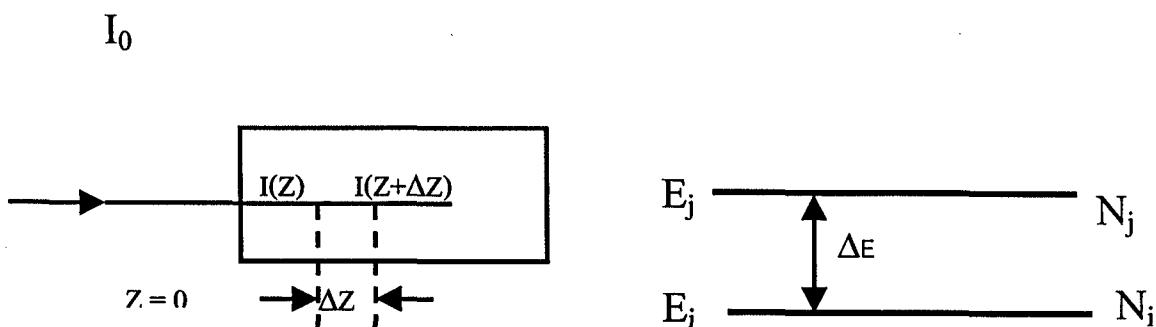
$$\text{เราพบว่าค่า } B_{01} = B_{10} \quad (2.8)$$

$$\text{และ } A_{10} = \frac{8\pi\eta\nu_{10}^3}{c^3} B_{10} \quad (2.9)$$

สมการ (2.8) และ (2.9) เรียกว่า Einstein Relations

สัมประสิทธิ์สมอัลซิกนอลเกน (Small signal gain coefficient)

เมื่อพิจารณาถึงแสงที่วิ่งผ่านวัตถุที่มีเนื้อไปร่องไสเท่ากันตลอด เราจะพบว่าความเข้มของแสงในตอนเริ่มต้น I_0 จะมีค่าเปลี่ยนไปเมื่อแสงเดินทางผ่านวัตถุนั้น



รูปที่ 2.3 แสดงถึงการเพิ่ม/ลดของความเข้มของแสงเมื่อผ่านเนื้อสาร

เราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลง $\Delta I(z)$ นั้นคือ

$$\Delta I(z) = I(z + \Delta z) - I(z) \quad (2.10)$$

$$\Delta I(z) = -\alpha I(z) \quad (2.11)$$

เมื่อ α เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืน (Absorption coefficient) จากสมการ (2.11) จะได้

$$\frac{dI(z)}{dz} = -\alpha I(z) \quad (2.12)$$

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z} \quad (2.13)$$

สมมติว่าในการที่แสงวิ่งเข้าไปในวัตถุเป็นระยะทาง Δz จำนวนไฟต่อนในแสงดูดกลืนไปเป็น n_{ij} ตั้งนั้นโดยสมการ (2.6) และ (2.7) เราจะได้

$$\begin{aligned} -\frac{dn_{ij}}{dt} &= N_i \frac{I(z)}{4\pi c} B_{ij} - N_j \frac{I(z)}{4\pi c} B_{ji} \\ &= B_{ij} (N_i - N_j) \frac{I(z)}{4\pi c} \end{aligned} \quad (2.14)$$

เมื่อ N_i และ N_j เป็นจำนวนอะตอมในระดับพลังงาน E_i และ E_j ตามลำดับ (ดูรูปที่ 2.3x) และในขณะเดียวกันเราสามารถหาจำนวนไฟต่อนที่ดูดกลืนไปในวัตถุขณะที่แสงวิ่งในเนื้อวัตถุเป็นระยะทาง z ได้อีกวิธีหนึ่งคือ

$$-\frac{dn_{ij}}{dt} = [I(z) - I(z + \Delta z)] \frac{A}{\eta \nu_{ij}} \quad (2.15)$$

เมื่อ A เป็นพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ ดังนั้นจะเห็นว่าสมการ (2.13) และ (2.14) มีค่าเท่ากันเพราะจะนี้

$$[I(z) - I(z + \Delta z)] \frac{A}{\eta \nu_{ij}} = B_{ij}(N_i - N_j) \frac{I(z)}{4\pi c} \quad (2.16)$$

แทนค่าสมการ (2.12) ใน (2.15) แล้วจัดเทอมใหม่จะได้

$$\alpha = B_{ij} \frac{(N_i - N_j)}{A \Delta z} \frac{h \nu_{ij}}{4\pi c} = B_{ij}(n_i - n_j) \frac{h \nu_{ij}}{4\pi c} \quad (2.17)$$

$n_i = N_i / A \Delta z$ และ $n_j = N_j / A \Delta z$ ก็อั่ม จำนวนอะตอมต่อหน่วยปริมาตรที่ค่าระดับพลังงาน E_i, E_j ตามลำดับ หรือเราจะเรียกว่า n_i, n_j จำนวนอะตอม/ปริมาตร ที่ค่าระดับพลังงาน E_i และ E_j ตามลำดับ

โดยทั่วไปแล้ว $N_i > N_j$ เมื่อ $E_i < E_j$ ซึ่งเป็นไปตามหลักของโบลซ์มาน (Boltzmann's Principal)

ดังนั้นจะเห็นว่า α จะมีค่าเป็นบวก (Positive) เมื่อ $N_i > N_j$ ในกรณีนี้ α จะเป็นสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (Absorption coefficient)

อย่างไรก็ตามหากเราสามารถมีวิธีการที่ทำให้ $N_j > N_i$ หรือ $n_j > n_i$ แล้วค่า α ในสมการที่ (2.17) จะเป็นค่าลบ (Negative) ดังนั้นความเชื่อมของแสงเมื่อวิ่งผ่านในเนื้อวัตถุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดูสมการ (2.13) เมื่อ α เป็นลบ (Negative)) ให้ $-\alpha = \beta$ ดังนั้นสมการ (2.13) จะเป็น

$$I(z) = I_0 e^{\beta z} ; \beta > 0 \quad (2.18)$$

$$\beta = B_{ij}(n_j - n_i) \frac{h \nu_{ij}}{4\pi c} \quad (2.19)$$

ค่า β เรียกว่าสัมประสิทธิ์สมอลซิกนัลเกน (Small signal gain coefficient)

ในกรณีที่ $n_j > n_i$ ซึ่งเรียกว่า Population inversion ในเนื้อวัตถุจะทำให้เกิดมีการขยายค่า (Amplification) ของความเชื่อมของแสงซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดเลเซอร์

2.1.3 เลเซอร์พัมป์ (Laser Pumping)

ตามหลักการของโบลซ์มาน (Boltzmann's Principal) จำนวนอะตอมในค่าระดับพลังงานต่ำ N_i จะมีค่ามากกว่า จำนวนอะตอมที่มีค่าระดับพลังงานสูง N_j เมื่อ $E_i < E_j$

$$E_j \xrightarrow{N_j} N_j = N_i \exp(-\Delta E_{ih} / kT) \quad (2.20)$$

$$\begin{array}{l} E_i \xrightarrow{N_i} N_i \\ \quad E_i < E_j \\ \quad N_i > N_j \end{array} \quad \Delta E_{ij} = E_j - E_i$$

รูปที่ 2.4 แสดงจำนวนอะตอมที่มีค่าระดับพลังงาน E_i, E_j

ในกรณีของสมการ (2.20) เราไม่สามารถก่อให้เกิดเลเซอร์ได้ เพราะไม่สามารถทำให้เกิด Population inversion ได้

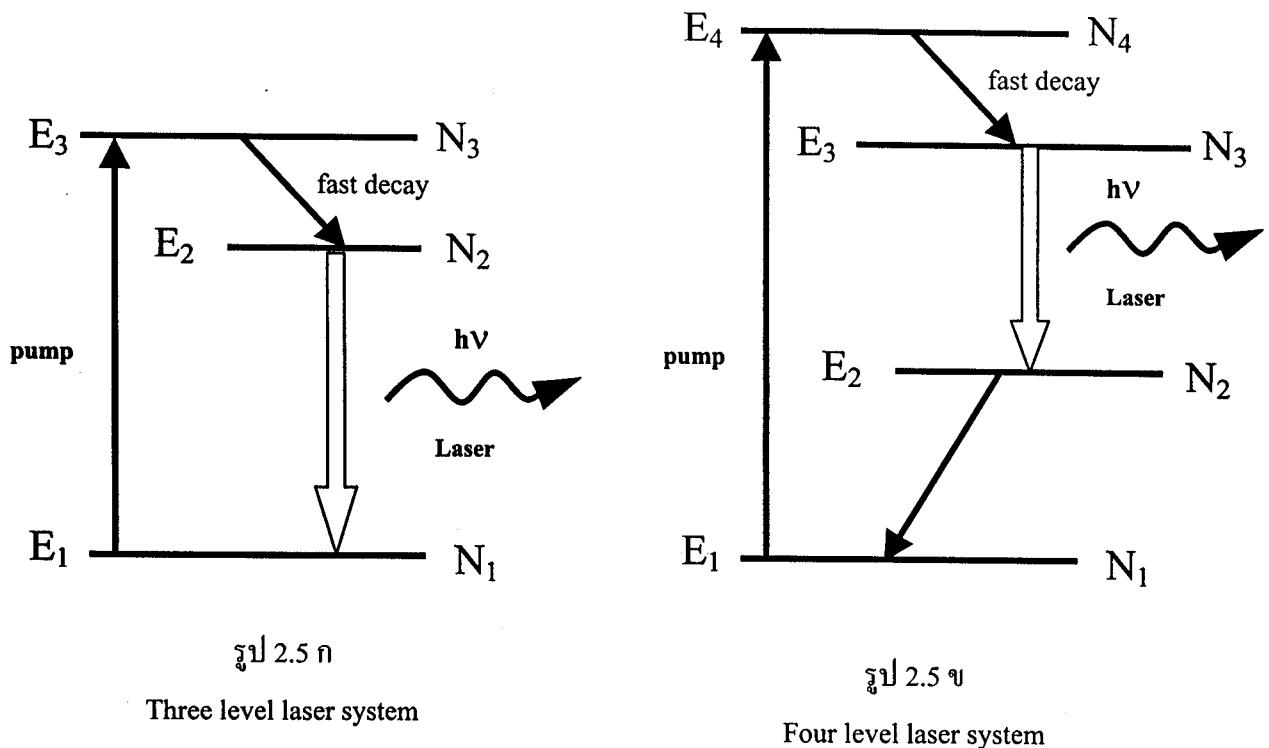
การทำให้เกิด Population inversion ($N_j > N_i$) จะทำได้โดยวิธีการเพิ่มพลังงาน (Pumping) วิธีการนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกวัสดุ (Laser medium) ที่เหมาะสมและวิธีเพิ่มพลังงาน (Pumping) ที่เหมาะสมเช่น Theodore Maiman (1960) ได้ทำเป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยใช้หันทิน (Ruby) เป็น laser medium การเพิ่มพลังงาน (Pumping) ให้แก่อะตอมในค่าระดับพลังงานต่ำเพื่อก่อให้เกิด $N_j > N_i$ กระทำได้หลายวิธี อาทิเช่น

- ใช้แสง (Optical pumping by flashlamp)
- ใช้แบบอิเล็กตรอนดิชาร์ท (Electron discharge)
- การชนด้วยอิเล็กตรอน (Electron beam bombardment)
- ใช้เลเซอร์ชนิดอื่นมาส่องกระแทบที่ทำให้มีการเปลี่ยนค่าระดับพลังงานในวัสดุ
- ปฏิบัติการทางเคมีที่ให้พลังงานจำนวนมากอย่างรวดเร็วเป็นต้น

ตัวอย่างการก่อให้เกิด $N_j > N_i$ ดังในรูป 2.5 ก, 2.5 ข

รูป 2.5 ก เป็นลักษณะการใช้ระดับพลังงาน 3 ระดับ (Three level laser) ในการก่อให้เกิด $N_j > N_i$ ($N_2 > N_1$) กล่าวคืออะตอม N_1 จะถูกให้พลังงานแล้วเปลี่ยนค่าระดับพลังงานไปอยู่ที่ระดับ E_3 เป็นจำนวน N_3 จากนั้น N_3 จะลดค่าพลังงาน (Decay) อย่างรวดเร็วมากอยู่ในระดับ E_2 เป็นจำนวน N_2 ซึ่งที่ระดับนี้อะตอมจะพักอยู่ได้นาน (Long relaxation time) ดังนั้นจำนวน $N_2 > N_1$ วิธีการนี้การทำให้ $N_2 > N_1$ ทำได้ยาก ต้องใช้พัมพ์ให้พลังงานมาก แสดงเลเซอร์เกิดจากการเปลี่ยนค่าระดับพลังงานจาก $E_2 \rightarrow E_1$ ของอะตอม N_2 แล้วในขณะเดียวกันก็ปล่อยโฟตอน (เลเซอร์) ที่มีพลังงาน

$E = h\nu_{21}$ ออกรadiaiton โดยวิธี Stimulated emission วิธีการนี้ใช้ในระบบ ruby เลเซอร์ (Ruby laser)



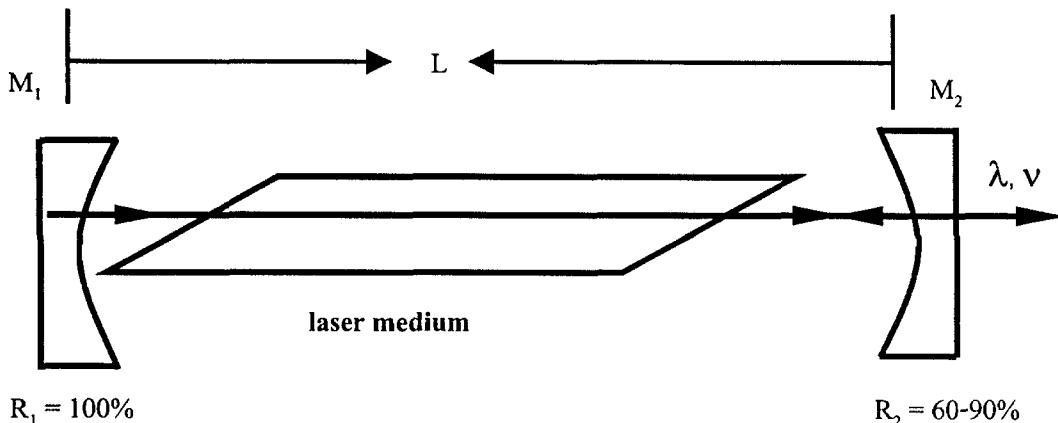
รูป 2.5 แสดงหลักการเกิดเลเซอร์แบบสามระดับและสี่ระดับ
(Three Level and Four Level Lasers)

รูป 2.5 ข เป็นลักษณะการใช้ระดับพลังงาน 4 ระดับ (Four level laser) ในการก่อให้เกิด $N_j > N_i$ ($N_3 > N_2$) กล่าวคือถ้าตอม N_1 จะถูกให้พลังงาน แล้วเปลี่ยนค่าระดับพลังงานอยู่ที่ E_4 เป็นจำนวน N_4 และ N_4 จะลดค่าระดับพลังงาน (Decay) อย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ E_3 เป็นจำนวน N_3 แล้วจึงเกิดการเปลี่ยนค่าพลังงานมาสู่ E_2 เกิดการปล่อยโฟตอนที่มีพลังงาน $E = h\nu_{32}$ (เลเซอร์) โดยขบวนการ Stimulated emission เมื่อมาอยู่ที่ E_2 เป็นจำนวน N_2 และ N_2 จะลดค่าพลังงานมาสู่ E_1 อย่างรวดเร็ว ทำให้ $N_3 > N_2$ อยู่เสมอ (ขณะเดียวกันยังมี Pumping อยู่) ข้อสังเกตที่ว่า $\Delta E = E_2 - E_1 > kT$ นั้นจะเป็นเพื่อป้องกันมิให้อัตราตอม N_1 ไปสู่ N_2 โดยขบวนการ Thermal excitation ทำให้ $N_3 > N_2$ อยู่เสมอ ในขณะที่มีการ Pumping อยู่ วิธีการใช้พลังงาน 4 ระดับ (Four level laser) นิยมใช้มาก เพราะไม่ต้องใช้พัมพ์ที่ให้

พลังงานสูงและการเกิด $N_3 > N_2$ จ่ายและสะดักดิ ทำให้ประสิทธิภาพการเกิดเลเซอร์สูง ระบบนี้โดยเดิมแบบ (Nd:YAG) เลเซอร์นี้เป็นไปตามกระบวนการ การเกิดเลเซอร์แบบ Four level laser

2.1.4 ออฟติคอลเรโซเนเตอร์ (Optical Resonator)

เพื่อที่จะทำให้เกิดมีการเพิ่มข่าย (Amplification) พลังงานของลำแสงเลเซอร์ที่ออกมานานาขึ้นจึงเป็นต้องมีเรโซเนเตอร์ เรโซเนเตอร์ประกอบด้วยกระจกที่ปิดด้วยไครอเดลิกทริก (Dielectrict coated mirror) ซึ่งจะบอนให้แสงที่มีช่วงคลื่น (λ) ของเลเซอร์เท่านั้นที่สะท้อนกลับ/ผ่านทะลุออกไป ทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันมิให้แสงที่ช่วงคลื่น λ อื่นๆ นารบกวนโดยทั่วไปเรโซเนเตอร์ประกอบด้วยกระจก 2 แผ่น M_1 , M_2 ดังในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 แสดงการจัดระบบเลเซอร์ที่ประกอบด้วยเลเซอร์มีเดิม และเรโซเนเตอร์ cavity

M_1 และ M_2 มีค่าสะท้อนกลับ (Reflectivity) 100% และ 60-90% ตามลำดับ ที่ช่วงคลื่นของเลเซอร์ ทุกครั้งที่เกิด Stimulated emission ไฟตอนจะวิงกลับไปมาสะท้อนระหว่าง M_1 , M_2 และถูกเพิ่มข่ายความเข้มเมื่อวิงผ่าน Laser medium จนกระทั่งจุดที่เกิดเลเซอร์ออสซิเลชั่น (Laser oscillation) ลำแสงเลเซอร์จะวิงออกทางกระจก M_2 การเกิดเลเซอร์ออสซิเลชั่นใน Laser medium นั้นมีเงื่อนไขที่ว่า เกน (Gain) ของเลเซอร์ออสซิเล

ขั้นมีค่าเท่ากับ การสูญเสีย (Loss) ของเรโซเนเตอร์ ในกรณีนี้เรียกว่า เทรส โอลเกน (Threshold gain) β_{th}

สมมติ M_1 และ M_2 มีค่าสะท้อนกลับเป็น R_1 และ R_2 ตามลำดับ และ α_e เป็นการสูญเสีย (พลังงาน)/ระยะทาง (Loss/Length) และ L เป็นระยะทางระหว่าง M_1 และ M_2 เราจะพบว่า

$$I = I_0 e^{(\beta - \alpha_e)L} \quad (2.21)$$

หลังจากสะท้อนกลับจากกระจก M_2 เราจะพบว่าความเข้มจะกลายเป็น

$$R_2 \exp[(\beta - \alpha_e)L]$$

และเมื่อสะท้อนกลับที่ M_1 (ครบ 1 รอบพอดี) ความเข้มของแสงจะเพิ่มเป็น

$$\begin{aligned} G &= R_1 R_2 \exp[2(\beta - \alpha_e)L] \\ &= \frac{\text{ความเข้มของแสงภายในครบ 1 รอบ}}{\text{ความเข้มของแสงเมื่อตอนเริ่มต้น}} \end{aligned} \quad (2.22)$$

ค่า G เรียกว่า เนตร้าวทริปเพาเวอร์เกน (Net round trip power gain) ถ้าค่า $G > 1$ แสดงว่า มีการเพิ่มค่าพลังงานของลำแสงภายใน Cavity

$G < 1$ แสดงว่า มีการลดค่าพลังงานของลำแสงภายใน Cavity

ที่ Threshold condition สำหรับ Laser oscillation เราจะได้

$$G = 1 = R_1 R_2 \exp[2(\beta_{th} - \alpha_e)L] \quad (2.23)$$

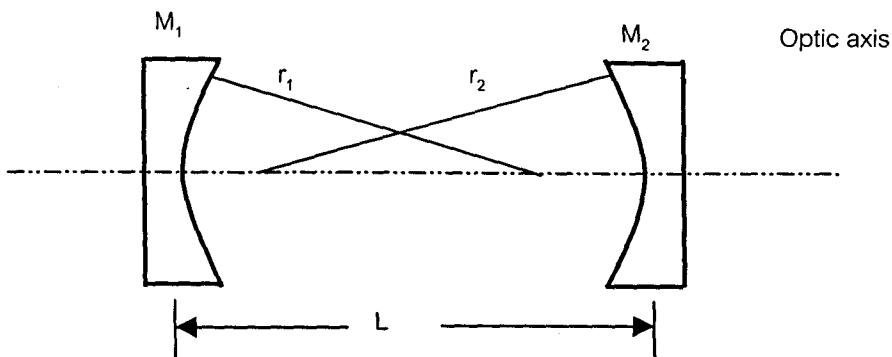
จากสมการ (2.22) จะได้

$$\beta_{th} = \alpha_e + \frac{1}{2L} \ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) = \alpha_e + \alpha_0 \quad (2.24)$$

α_e คือการสูญเสียพลังงานของลำแสงเดлезอร์ในการดูดกลืนและScattering ภายใน Laser medium

α_0 คือการสูญเสียพลังงานในส่วนที่กล้ายเป็นลำแสงเดлезอร์ออกนอกกระจก M_2

ดังนั้นจากสมการ (2.24) เราพอสรุปได้ว่าในกรณีสเตดดีสเตทเดлезอร์ ออสซิลเลชัน (Steady state laser oscillation) เกน (Gain) จะมีค่าเท่ากับผลรวมของลอส (Loss) ในเดлезอร์ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ชนิดของกระจกและการจัดระหว่าง L ระหว่างกระจก M_1 และ M_2 ให้พอดีมากเพื่อที่จะทำให้เกิดมีสเตบิลิตี้ (Stability) ในการสะท้อนกลับไปมาของแสงระหว่าง M_1 , M_2 ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้เกิดมีการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะทำให้เกิดเดлезอร์ออสซิลเลชันได้จริง



รูปที่ 2.7 แสดงการจัดเรขาคณetc. คาวิตี้

ให้ r_1, r_2 เป็นรัศมีความโค้งของผิวกระจก M_1, M_2 ตามลำดับ

$$\text{ให้ } g_1 = 1 - \frac{L}{r_1}, \quad g_2 = 1 - \frac{L}{r_2} \quad (2.25)$$

กำหนดให้ $r_1 > 0$ เมื่อผิวโค้งด้านในของกระจกหันเข้าหากavity (บริเวณระหว่างกระจก M_1 และ M_2) เราจะพบว่า สเตบิลิตี้ของเรขาคณetc. (Boyd and Gordon, 1961; Boyd and Kogelnik, 1962) จะเกิดขึ้นเมื่อ

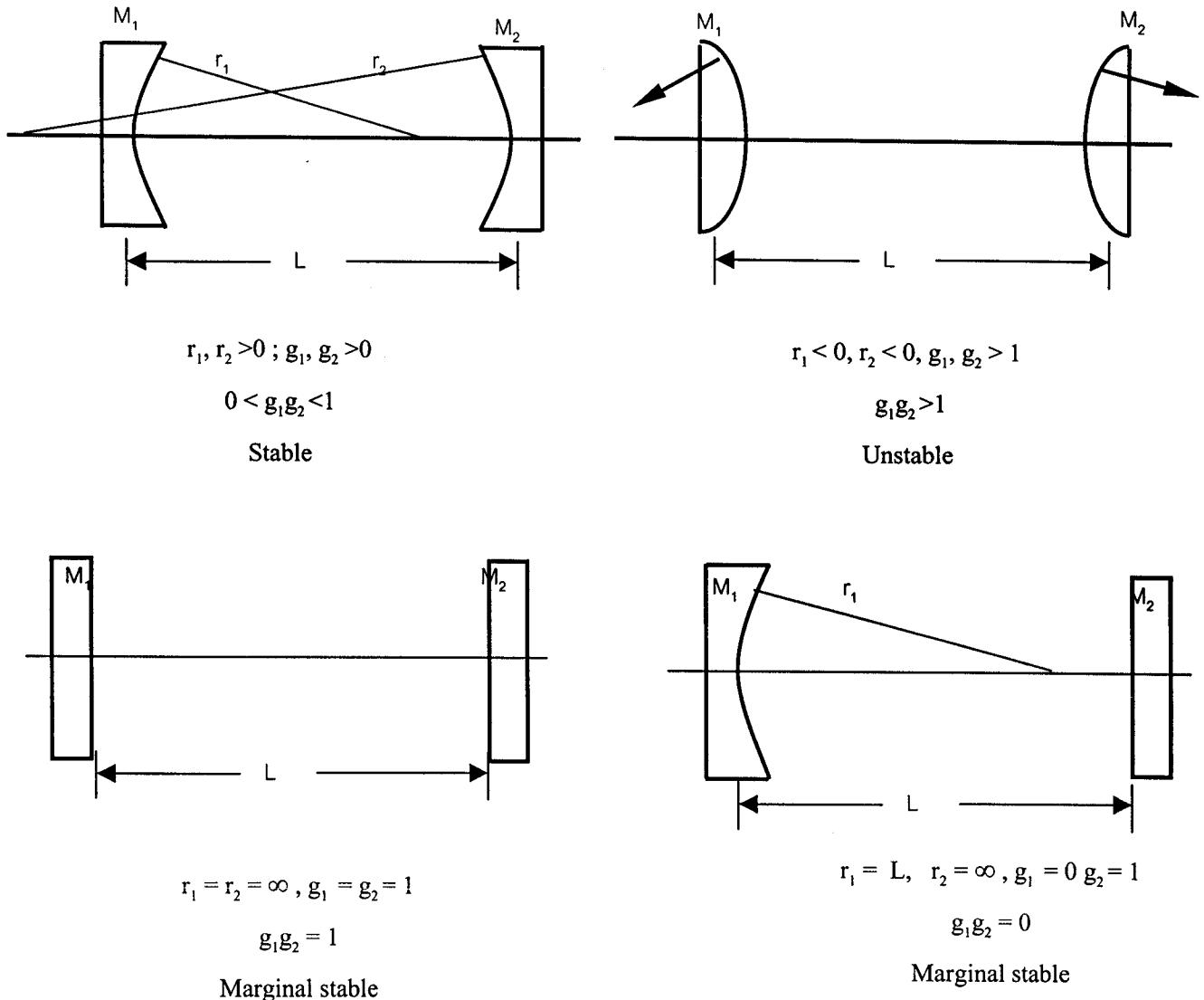
$$0 < g_1 g_2 < 1 \quad (2.26)$$

และเรขาคณetc. จะอันสเตบิลิตี้ เมื่อ

$$g_1 g_2 < 0, \quad g_1 g_2 > 1 \quad (2.27)$$

ถ้า $\left. \begin{array}{l} g_1 g_2 = 0 \\ g_1 g_2 = 1 \end{array} \right\}$ เรียกว่า นาร์จินนัลสเตบิลิตี้ (Marginal stability)
หรือ

ตัวอย่างของ สเตบิลิตี้, อันสเตบิลิตี้, และนาร์จินนัลสเตบิลิตี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.8

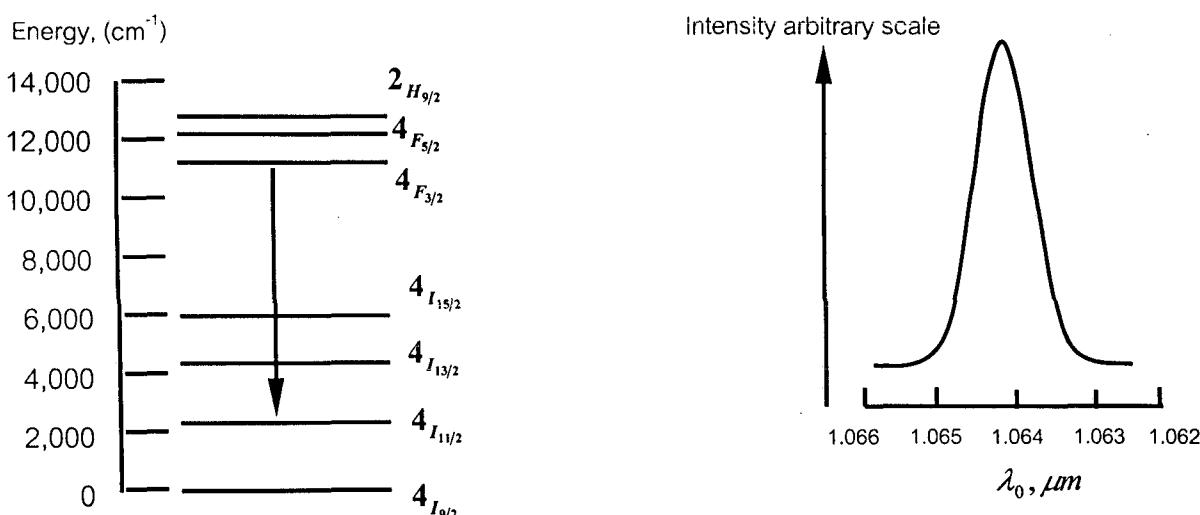


รูปที่ 2.8 แสดงการจัดวางริโซเนเตอร์คาวิตี้แบบต่างๆ

2.2 ระบบไนโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ (Nd: YAG Laser System)

ระบบไนโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ (Nd: YAG Laser) เป็นระบบโซลิดสเตตเลเซอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี ค.ศ. 1964 J. E. Geusic, et.al.(1964) ได้ทำการศึกษาและประสบผลสำเร็จในการทำให้เกิดแสงนิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ เลเซอร์ระบบนี้มีเลเซอร์มีเดียมเป็นแท่งผลึก Nd:YAG โดยการนำนิโอดิเมียมไอออน Nd^{3+} ไปเป็นอิมเพิริตี้ (Impurity) ในโครง (Host) ของยิทเทริยมอะซูมิเนียมการ์เนท (Yttrium Aluminum Garnet; YAG; $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$) และเลเซอร์ที่ได้ออกมาเกิดจากการเกิดประชาน

ผลกระทบนั้นทำโดยการใช้แฟลชแลมป์ที่บรรจุแกสเซนอน(Xenon flashlamp) ที่ให้ความเข้มของแสงสูงทำให้การพัมพ์แท่งหลักนีโอดิเมียมแข็ง (Nd:YAG rod) แท่ง Nd: YAG มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงในช่วงความถี่ที่คล้ายๆ ช่วงของスペกตรัมที่ได้จากซีนอนแฟลชแลมป์ (Xenon flashlamp) ส่องออกมานะแสงเลเซอร์ที่เกิดจากแท่ง Nd: YAG จะมีความยาวคลื่น $\lambda = 1064\text{ nm}$ ที่อุณหภูมิห้อง ($T = 300^\circ\text{K}$) เนื่องจากระดับพลังงานของการเกิดสติ๊มูลเดดเต็ม อิมิชั่นใน Nd: YAG นั้นอยู่ห่างจากกราวน์สเตท (Ground state) มาก ดังนั้นที่อุณหภูมิของห้องโอกาสที่อะตอมของ Nd ในระดับกราวน์สเตทจะไม่มีโอกาสกระโดดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเลเซอร์ ดังนั้นระบบ Nd:YAG เลเซอร์จึงนับได้ว่าเป็นระบบเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับ 4 ระดับพลังงาน (Four level laser) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้น อะตอมของนีโอดิเมียมที่ฟังตัวอยู่ในโครงหลัก $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_1_2$ เมื่อได้รับพลังงานจากการพัมพ์ของซีนอนแฟลชแลมป์ จะถูกกระตุ้นไปสู่ระดับสูง และการเปลี่ยนระดับพลังงานลดลงมาสู่ระดับ $^4F_{3/2}$ และเกิดสติ๊มูลเดดเต็ม อิมิชั่นระหว่างระดับ $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$ โดยที่การเกิดประชาระดับพกผันระหว่างระดับหั้งสองนี้อยู่ก่อนแล้ว ดังในรูป 2.9



รูปที่ 2.9 แสดงระดับพลังงานของ Nd:YAG และการเกิดแสงเลเซอร์จากการเปลี่ยนระดับ พลังงาน $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$

รูปที่ 2.10 แสดงสปอนเทเนียสอิมิชั่น สเปกตรัมของ Nd: YAG บริเวณร่างไกส์ เคียง $\lambda_0 = 1.0604 \mu\text{m}$

แสงเลเซอร์ที่ออกแบบมีความยาวคลื่น $\lambda_0 = 1064 \text{ nm}$ รูปที่ 2.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอะตอม Nd:YAG จาก $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{1/2}$ ที่อุณหภูมิห้องเราพบว่าเกนของ Nd:YAG มีค่าสูงกว่าเกนของแท่งรูปปะน้ำ้ 75 เท่า (Yariv, 1989) ดังนั้นเราจะพนว่าการทําให้เกิดแสงเลเซอร์จาก Nd:YAG ได้ 2 แบบคือ แบบที่เป็นช่วง (Pulse) และแบบที่ต่อเนื่อง (Continuous wave, CW)

2.3 คิวสวิตช์เลเซอร์พลัส

ตามที่ได้ศึกษาถึงการเกิดแสงเลเซอร์ซึ่งได้จากการแอมแพลฟายสต็อกเลดเต็ค อัมฟิสชั่น (Amplified Stimulated Emission) ของคลื่นแม่เหลือกไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าระดับพลังงานของอะตอมจากสเตท $|2\rangle \rightarrow |1\rangle$ ดังที่ได้นำรายในตอนต้น นอกจานี้การเกิดแสงเลเซอร์ที่ออกแบบเป็นรูปแบบพลัส (Pulse) ของระบบโซลิคสเตทเลเซอร์นั้นประกอบเป็นพลัสขนาดเล็ก และพลังงานต่ำ จำนวนมากโดยที่มีความกว้างของพลัสมาก ($\approx 10^{-6} \text{ sec}$) พลัสเหล่านี้เป็นยอดแหลม (Spikes) ซึ่งยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแสงเลเซอร์ที่อยู่ในรูปแบบของแหลม (Spikes) เหล่านี้ให้เป็นพลัสขนาดใหญ่ (Giant pulse) เดียวกัน และมีความแคบของพลัสมากขึ้น $\approx 10^{-9} \text{ sec}$ (Nano-second) และนอกจานี้พลัสขนาดใหญ่ดังกล่าวจะเรียกว่า คิวสวิตช์ (Q-switch) ซึ่ง R.W. Hellwarth (1961) ได้ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการทําให้เกิดคิวสวิตช์พลัส (Q-switched Pulse) และต่อมา R. W. Hellwarth et. al. (1966) ได้ปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและมีความแน่นอนมากกว่าเดิม

2.3.1 หลักการและวิธีการผลิตคิวสวิตช์เลเซอร์พลัส วิธีการทําให้เกิดคิวสวิตช์พลัสนี้ทําได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าคิว (Q) ของเรโซเนเตอร์ให้ต่ำอยู่เสมอ ในขณะที่กำลังเกิดประชากรผูกกัน (Population inversion) เพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้ค่าเกน (Gain) $\beta(\nu)$ ของระบบมีค่าสูงซึ่งจะทำให้เกิดเลเซอร์ออกสัมภาระก่อนที่เราจะต้องการให้เกิด เมื่อรอให้ประชากรผูกกันมีจำนวนมากที่สุดแล้วเราจะจึงใช้เทคนิค

นางประการ (ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป) มาเปลี่ยนค่าคิว (Q) ของเรโซเนเตอร์ซึ่งเดิมเป็นค่าต่ำ (Low Q value) มาให้เป็นค่าสูง (High Q value) อี่างฉับพลัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเกน (Gain) $\beta(\nu)$ สูงที่สุดทำให้เกิดการขยาย (Amplification) ของความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเลเซอร์คาวิตี้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัลส์ขนาดใหญ่ (Giant pulse) เป็นแสงเลเซอร์ออกมาน การเกิดคิวสวิตท์เลเซอร์พัลส์ขนาดใหญ่นี้ทำให้จำนวนประชารอยกพันลคลงอย่างรวดเร็วและมีค่าต่ำกว่าค่าเทรสโซลด์เกน ดังนั้นเลเซอร์จะออกซิลเลทได้เพียงครั้งเดียว กล่าวคือ จะให้พัลส์ขนาดใหญ่ออกมานานนึงพัลส์ไม่ใช่เป็นขดแหลม (Spikes) จำนวนมากๆ อี่างที่เคยเป็นมา โดยปกติแล้วเราสามารถผลิตคิวสวิตท์พัลส์ (Q-switched Pulse) ที่มีพิกเพาเวอร์ (Peak power) สูงประมาณ 500 MW โดยมีพัลส์วิดธ์ (Pulsewidth) ประมาณ 10^{-9} วินาที (Nanosecond) ซึ่งเป็นพัลส์ที่แคมมาก และเมื่อทำการโฟกัสแสงเลเซอร์แบบคิวสวิตท์นี้ให้เล็กลงแล้ว เราจะได้ความหนาแน่นของกำลังงานสูงประมาณ $1-10 \text{ Gigawatt/cm}^2$ ซึ่งมีจุดความสามารถจ่ายไอออนไนซ์ (Ionized) หรือแยกสลาย (Breakdown) โนเกลุของแกสต่างๆ ในอากาศได้ง่ายดาย นอกจากนี้คิวสวิตท์เลเซอร์ยังมีจุดความสามารถเจาะทะลวงเหล็กกล้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

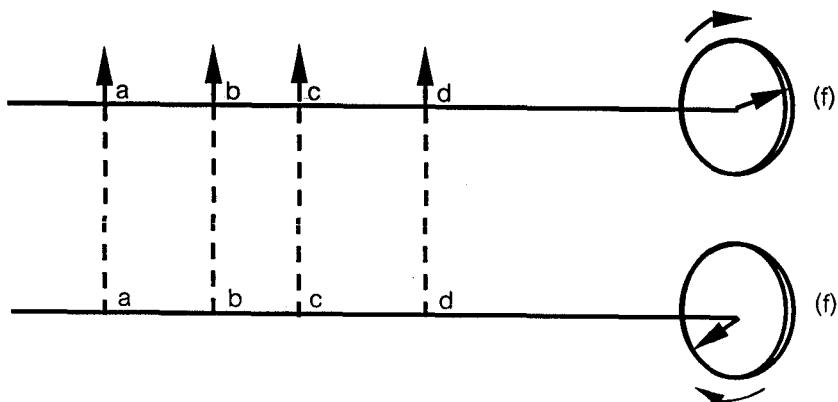
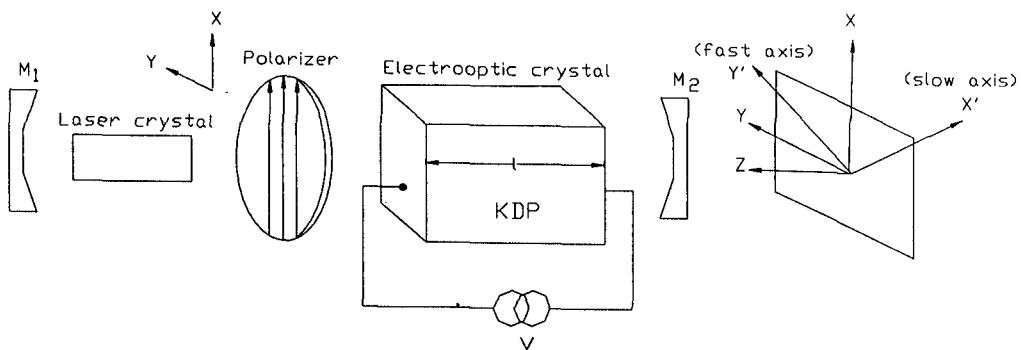
การทำให้เกิดคิวสวิตท์พัลส์นี้ ทำได้หลายวิธีการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ เราสามารถสรุปวิธีการทำให้เกิดคิวสวิตท์พัลส์ออกได้ 2 วิธี การวิธีการแรกคือ แบบแอ็คทีฟ (Active Method) วิธีการนี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า โรเตทติงเมียร์เรอร์ (Rotating Mirror) อะคูสติกชัทเตอร์ (Acoustic Shutter), อิเล็กโทรอฟติกชัทเตอร์ (Electro-Optics Shutter) วิธีการที่สองคือ แบบพาสซีฟ (Passive Method) ซึ่งวิธีการนี้ใช้หลักการดูดกลืน (Absorption) ของความเข้มของแสงโดยอะตอน/โนเกลุของบลิชเบิล黛ย์ (Bleachable dye)

สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การทำคิวสวิตท์เลเซอร์พัลส์แบบอิเล็กโทรอฟติกชัทเตอร์ เพราะสามารถควบคุมการเกิดคิวสวิตท์พัลส์ได้ง่าย

2.3.2 อิเล็กโทรอฟติกชัทเตอร์ (Electrooptic Shutter) วิธีการนี้ใช้ขบวนการอิเล็กโทรอฟติกเป็นชัทเตอร์ โดยใช้พอกเกลเซลล์ (Pockel Cell) ซึ่งมีพลีกโป๊แตสเซี่ยมไนโตรเจนฟอสเฟต (KDP- เป็นพลีกแบบเพียง

โซอิเล็กตริก) ออย'ในของเหลวและเมื่อให้ใบแอดสโอลเตจ (Bias voltage) กับ KDP แล้ว KDP จะเปลี่ยนโพลาไรเซชั่นของแสงในเลเซอร์คาวิตี้ ทำให้เกิดมีการสูญเสีย(Loss)มากขึ้นเพื่อบังกันเลเซอร์ออฟซิลิชั่นเกิดก่อนกำหนด การใช้พอกเคลเซลเป็นชั้บท่อร์สำหรับทำให้เกิดคิวสวิตท์เลเซอร์พัลล์ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.11

ในขณะที่แฟลชแอลมพ์กำลังพัมพ์เลเซอร์มีเดียม ศักดิ์ประมาณ 1.5 KV จะถูกส่งไปใบแอดที่พลีก KDP ในพอกเคลเซลจะทำให้แสงลินีเยอร์โพลาร์ต์ที่ตำแหน่ง d เมื่อผ่าน KDP จะมีการเปลี่ยนเฟสไป $\pi/2$ และกลไกเป็นเซอร์คูลาร์โพลาไรร์ (Circular polarized) และเมื่อสะท้อนที่กระจก M_2 (จุด f) และผ่าน KDP อีก แสงจะเปลี่ยนเฟสอีก $\pi/2$ ดังนั้นเมื่อกลับมาที่จุด d แสงจะมีการเปลี่ยนเฟสร่วมเป็น π ซึ่งจะลินีเยอร์โพลาไรเซชั่น (Linear Polarization) แต่แนวแกนจะหมุนไป 90° จากเดิมทำให้แนวของโพลาไรเซชั่นตั้งฉากกับแนวของแผ่นโพลาไรเซอร์ (Polarizer) ดังนั้นแสงจะถูกสะท้อนไว้โดยโพลาไรเซอร์ ขณะนั้นพอกเคลเซลทำงานที่เหมือนชั้บท่อร์ที่ปิด ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีประชากรพกผันมากและเกน (Gain) มากกว่า β_{th} ก็ตาม จะไม่มีเลเซอร์ออฟซิลเลชั่นเกิดเพราค่าคิว (Q) ของเรโซเนเตอร์ต่ำมาก เมื่อเราตั้งเวลาการทำงานของพอกเคลเซลให้พอเหมาะสม คือในช่วงเวลาที่เหมาะสมศักดิ์ที่ใบแอด KDP ไว้จะหยุดพอกเคลเซลหยุดทำงานทำให้แสงภายในเรโซเนเตอร์สะท้อนกลับไปมาระหว่าง M_1 และ M_2 ทำให้เกิดการแอมป์ลิฟายส์ติมูลเดดเต็ดอิมิสชั่นขึ้น และเลเซอร์พัลล์ขนาดใหญ่ก็จะเกิดตามมาเป็นคิวสวิตท์เลเซอร์พัลล์ ซึ่งมีกำลังสูงและพัลล์วิคท์ประมาณ 10^{-9} sec การทำคิวสวิตท์พัลล์โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะสามารถทำขนาดและรูปแบบของพัลล์ได้เหมือนกันทุกครั้งที่ทำซ้ำๆ กันได้ผลดีเสมอ



At point d,

$$\left. \begin{aligned} E'_x &= \frac{E}{\sqrt{2}} \cos \omega t \\ E'_y &= \frac{E}{\sqrt{2}} \cos \omega t \end{aligned} \right\}$$

The optical field is linear polarized with its electric field vector parallel to x

$$\left. \begin{aligned} E'_x &= \frac{-E}{\sqrt{2}} \cos (\omega + kl + \frac{\pi}{2}) \\ E'_y &= \frac{-E}{\sqrt{2}} \cos (\omega + kl) \end{aligned} \right\}$$

Circular polarized

At point f,

$$\left. \begin{aligned} E'_x &= \frac{E}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + kl + \frac{\pi}{2}) \\ E'_y &= \frac{E}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + kl) \end{aligned} \right\}$$

Circularly polarized

$$\left. \begin{aligned} E'_x &= \frac{-E}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + 2kl + \pi) \\ E'_y &= \frac{-E}{\sqrt{2}} \cos(\omega t + 2kl) \end{aligned} \right\}$$

Linear polarized along y

At point f,

At point d,

รูปที่ 2.11 แสดงการใช้วิธีอเล็ก troptics จากพอก
เคลเซลล์ (Pockel Cell) เพื่อการเกิดคิวสวิตท์เลเซอร์พัลล์

บทที่ 3

การสร้างระบบเลเซอร์

บทนำ

ในการสร้างระบบนิโอดิเมียมแยกลaser (Neodymium YAG Laser System) นั้น ผู้วิจัยได้คำนึงถึงระบบที่ประกอบด้วย กระจกเลเซอร์ที่ปิดค้าน้ำและค้าน้ำท้ายของเลเซอร์คาวิตี และจะต้องทำให้ขนาดของระบบเล็กพอดีไปใช้ในงานภาคสนาม ทั้งนี้ตัวระบบจะต้องมีขนาดกระหัตครัծและให้พลังงานของเลเซอร์ในระดับไม่สูงนัก แต่จะมี Peak Power สูงพอที่จะทำงานได้ ในการออกแบบการสร้างระบบนี้ส่วนสำคัญคือ การออกแบบเลเซอร์คาวิตี (Laser Cavity) การออกแบบระบบจ่ายกำลัง (Power Supply) และการเลือกขนาดของแท่งหลักนิโอดิเมียม นอกจากนี้ได้มีการเลือกรอบ การจัดวางกระจกของระบบเลเซอร์โดยจะทำให้ระบบเลเซอร์มีเสถียรภาพมากที่สุดและไม่บุ่มยากในการปรับตำแหน่งของกระจก

3.1 การออกแบบหัวเลเซอร์ (Laser Head)

เนื่องจากหัวเลเซอร์จะต้องมีขนาดกระหัตครัծและคงทนในการใช้ในภาคสนาม ดังนี้หัวเลเซอร์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนแสงแฟลชแอลมพ์ จึงจำเป็นต้องเป็นโลหะและเบา ดังนั้นจึงใช้ทองเหลือง (Brass) เป็นหัวเลเซอร์ เพราะสามารถซูบทองคำได้ภายในจะใส่หลอดคลินีเยอร์แฟลชแอลมพ์ (Linear flashlamp) จะมีแท่งหลักนิโอดิเมียมวางขานานอยู่ภายในหัวเลเซอร์ จะต้องใส่ของเหลว Galden 5 ซึ่งเป็นของเหลวที่ปะรุงใส่ในช่วงคลื่น 400-15000 nm และมีคุณสมบัติในการทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความจุความร้อนสูง ทั้งนี้เพื่อจะเป็นตัวคูดคลื่นความร้อนอันเกิดจากการที่แฟลชแอลมพ์ทำ การปลดปล่อยแสงออกมากเพียงแค่หลักนิโอดิเมียม และขณะเดียวกันก็เกิดความร้อนออกมากจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้วระบบเลเซอร์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมักจะอยู่กับที่ ดังนั้นเราอาจจะใช้การระบายน้ำความร้อนด้วยอากาศ หรือการหล่อให้เย็นด้วยน้ำที่ไหลวน เพื่อการระบายน้ำความร้อน แต่เนื่องจากระบบเลเซอร์ตั้งกล่าวว่านี้ออกแบบเพื่อใช้งานในภาคสนามและสามารถใช้ใน เลเซอร์ซึ่ง ฯ กันในเวลาอันจำกัด ดังนั้นจะต้องมีตัวระบายน้ำความร้อนที่ดี กล่าวคือ มีความจุความร้อนสูงและทนทานต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นในการออกแบบ

แบบหัวเดเซอร์จึงจะต้องเป็นระบบปิดคือต้องใช้โอริง (Oring) ที่กันการรั่วซึ่นของของเหลวออกมานาทางรอยต่อของระบบกันแท่งพลาสติกนิโอดิเมียม และรอยต่อของหลอดแฟลชแลมพ์ซึ่งเป็นแก้วกับขอบของภาวีตี้ หัวเดเซอร์ที่ 1 จากแท่งทองเหลืองที่มีขนาด $4.5 \times 5.0 \times 6.0$ ซม.³ โดยใช้การสกัดขี้นรูป (Lathed) ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.1 แสดงการขัดความระบบ Nd:YAG เดเซอร์ พร้อมเครื่องจ่ายกำลัง

รูปที่ 3.2 แสดงรูปเลเซอร์คาวตี และตัวแทน'งที่ใส่แฟลช์แอลมพ์
และแท่งผลีกนิโอดิเมียม

เพื่อจะกันการรั่วซึมของของเหลวออกจากหัวเลเซอร์ เราใช้ซิลิโคน โอริง (Silicon O ring) ซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงโดยไม่มีการยืดหยุ่น เลเซอร์คาวิตี ประกอบด้วยชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 2 ชิ้น ซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันโดยมีซิลิโคน โอริงอยู่ตรงกลางแล้วจะทำให้เกิดช่องไฟฟ้าที่ว่างเป็นลักษณะของแบบคล้าย Ellipse ทำให้เกิดคาวิตี (Cavity) แบบ Closed Coupling ผนังค้านในของหัวเลเซอร์ จะต้องขัดมันเพื่อการสะท้อนกลับของแสงแฟลชแอลมพ์ทั้งหมดพุ่งเข้าสู่แท่งผลึกอย่างสม่ำเสมอต่อการยิงเลเซอร์ทุก ๆ ครั้ง นอกจากนี้เพื่อให้การสะท้อนกลับหมด (Total reflection) เกิดมากที่สุด เราจำเป็นต้องขับเคลื่อนผิวค้านในของหัวเลเซอร์ด้วยทองคำ ในการทำเลเซอร์คาวิตีในครั้งแรกนั้นเราใช้อะลูมิเนียม ซึ่งปรากฏว่าพบความยากลำบากมากในการขับทองและต่อมานพบว่าหากเปลี่ยนเป็นทองเหลืองแล้วการขับทองจะทำได้ง่ายและสามารถขับทองได้หนาขึ้น เราทราบกันดีว่าผิวโลหะทองจะสะท้อนแสงได้อย่างดีในข้างซ้ายความถี่ที่ตามองเห็นไปถึงข้างนอกฟาราเดค (Koechner, 1976) ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำออฟทิคอลพัมพ์พิง (Optical pumping) เพื่อการเกิดเลเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนทองผิวสะท้อนกลับ (Reflecting surface) ของหัวเลเซอร์

3.2 การออกแบบระบบจ่ายกำลัง (Power Supply)

ในการออกแบบเครื่องจ่ายกำลังนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบจ่ายกำลังที่ต้องจ่ายกำลังให้หลอดแฟลชแอลมพ์ทำงานให้แสงสว่างเป็นช่วง ๆ (Pulse) ซึ่งแสดงจากหลอดแฟลชแอลมพ์นี้ประกอบด้วย แอบสเปกตรัมที่กว้าง (Broad band spectrum) ซึ่งทำให้เกิดอัฟติคอลพัมพ์พิงในแท่งผลึกเลเซอร์ เป็นอย่างดี ในการออกแบบนั้นได้คำนึงถึงการใช้งานค่าประกอบและวัสดุทางไฟฟ้าที่หากรายในห้องทดลองและเหมาะสมกับพื้นความรู้ทั่วไปทางอิเล็กทรอนิกส์ของช่วงที่จะมาสร้างประกอบ กล่าวคือใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น (Indigenous technology) ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการสร้างและซ่อมบำรุงดังนั้นจะเห็นว่าระบบจ่ายกำลังจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งก็สามารถทำให้เล็กกระหัคลดลงมาได้หากจะพัฒนาต่อไปอีก

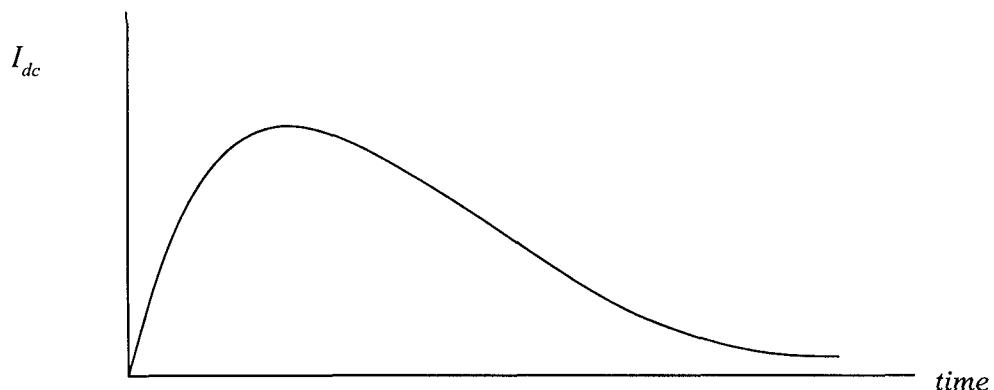
วงจรของเครื่องจ่ายกำลังนี้ได้แสดงไว้ในรูป 3.3 ซึ่งประกอบด้วยวงจรทางไฟฟ้าอยู่ ๆ มาประกอบกัน กล่าวคือจะเป็นวงจรที่กระตุ้น (Trigger) การทำงานของการเกิดประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเก็บประจุ (Capacitor) และวงจร

ชาร์ตประจุเข้าไปเก็บในตัวเก็บประจุ นอกจากนี้การเพิ่มค่าความจุของตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระทำได้โดยการเพิ่มสักค่าไฟฟ้า (Voltage) ระหว่างขั้วของตัวเก็บประจุ ทั้งนี้กระทำได้โดยการใช้วาริแอค (Variac) ซึ่งสามารถเพิ่มสักค่าไฟฟ้าได้ระหว่าง 0-3000 โวลท์ ดังนั้นระบบจ่ายก็ ลังนี้สามารถให้สักค่าไฟฟ้าได้ในช่วง 0-3000 โวลท์ และกระแสไฟตรงไฟล์เข้าสู่หลอดแฟลชและไฟ

รูปที่ 3.3 แสดงวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของระบบจ่ายกําลัง (Power Supply)

ประมาณ 20 มิลลิแอมป์ (mA) ตัวเก็บประจุที่ใช้ในเครื่องจ่ายกำลังนี้มีขนาด การเก็บประจุ $2 \times 40 \mu\text{F}$ ผลิตโดยบริษัท Siemens และทาง Max Planck Institute, Gottingen ได้ให้ความช่วยเหลือ โดย Prof. F. P. Schacfer ในการบริจาคตัวเก็บประจุนี้ให้ในการออกแบบสร้างระบบจ่ายกำลัง

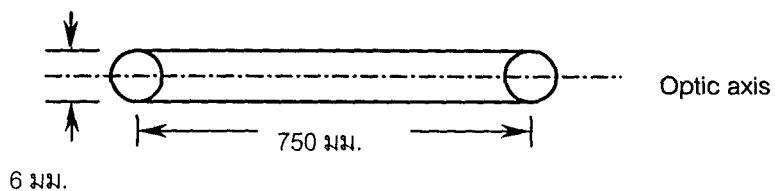
ในการออกแบบระบบจ่ายกำลังนี้ผู้วิจัยได้ทราบนักเป็นอย่างดีในการจ่ายกระแสไฟตรงไปยังแฟลชแอลมพ์ ทั้งนี้กระแสตรงที่เข้าแฟลชแอลมพ์นั้นจะต้องไม่มีการไหลข้อนกลับ เพราะแฟลชแอลมพ์มีโพลาริตี้ที่แน่นอน หากมีการไหลข้อนกลับของกระแสไฟตรงในแฟลชแอลมพ์ จะทำให้แฟลชแอลมพ์ระเบิด ทำความเสียหายต่อเลเซอร์คาวิตี้ แท่งหลักเลเซอร์และเป็นอันตรายต่อนยนต์ตาและใบหน้าของผู้ทำการทดลองอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการออกแบบเป็นพิเศษ โดยคำนวณให้การจ่ายกระแสไฟตรงจากตัวเก็บประจุ (Capacitor) ไปยังหลอดแฟลชแอลมพ์เป็นไปอย่างที่เรียกว่า “Critical damp discharge” ดังแสดงในรูป 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงการจ่ายกระแสไฟตรงจากตัวเก็บประจุ (Capacitor) ไปยังแฟลชแอลมพ์เป็นไปแบบ Critical damp discharge

3.3 แท่งพลีกนิโอดิเมียมแย็ก (Neodymium YAG crystal)

เนื่องจาก การทำแท่งพลีกนิโอดิเมียมแย็ก เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน และต้องมีการ “เติม” (Dope) อะตอน Nd^{+3} ลงไปในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่พอเหมาะ (ประมาณ 0.01 - 0.5%) กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เรียกว่า อินพิวาริตี้โดปปิง (Impurity Doping) กระบวนการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีสูงและไม่สามารถทำได้ในประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสั่งผลิต Nd : YAG จากบริษัท Union Carbide Inc., U.S.A. โดยมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกยาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และยาว 750 มม. โดยปลายทั้งสองต้องตั้งฉากกับแกนยาวของแท่งดังในรูปที่ 3.5



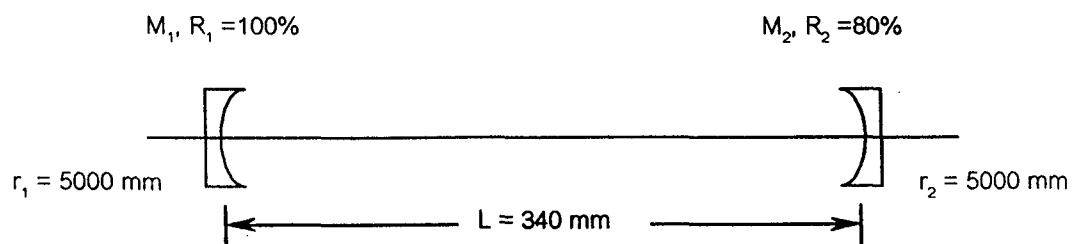
รูปที่ 3.5 แสดงขนาดและการวางตัวของพลีกในแท่งนิโอดิเมียมแย็ก

การตัดลักษณะนี้เรียกว่าแบบ ซีคัท (C-cut) เพราะหน้าตัดของพลีกทั้งสองปลายจะตั้งฉากกับแกนของพลีกซึ่งอยู่ในแนวแกนออฟติก (Optic axis) แท่งพลีกนิโอดิเมียมที่ตัดในลักษณะซีคัท (C-cut) นี้ จะทำให้แสงเลเซอร์ที่ออกมามีโพลาไรเซชันเป็นแบบラン-dom (Random polarization) โดยมีพิษทางของสนามไฟฟ้า (\vec{E}) ทุกทิศทาง

3.4 การจัดวางกระบวนการเลเซอร์

ในการออกแบบระบบเลเซอร์ ได้มีการใช้กระจกเคลือบสารไออิเล็กตริกหลายชั้น โดยกำหนดให้การเคลือบสารนี้ ทำให้กระจกมีคุณสมบัติสะท้อนแสงเดเซอร์ที่ $\lambda = 1064$ นาโนเมตร โดยให้ค่าสะท้อนแสงของกระจก M_1 มีค่า $R_1 = 100\%$ และกระจก M_2 มีค่า $R_2 = 80\%$ เพื่อให้เกิดอัตราการ反射率 R ที่มีค่าสูง กำหนดให้กระจก M_1 และ M_2 มีรัศมีความโค้ง (Radius of curvature) $r_1 = r_2 = 50000$ มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างกระจก M_1 และ M_2

มีค่า $L=340$ มิลลิเมตร คั่งนี้น้อยกว่าครึ่งเดือนเดือนจะเป็นแบบ Nearly planar ($r_1 = r_2 \gg L$) ตามที่แสดงไว้ในบทที่ 2



รูปที่ 3.6 แสดงการจัดวางกระชาก M_1 และ M_2 ของสองพิคอลเรไซเนเดอร์ $L=340$ มิลลิเมตร

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการจัดการทดลองเพื่อทำการวัดค่าตัวแปรต่างๆ ของระบบเลเซอร์ในขอบข่ายที่เครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมที่มีอยู่ ในการจัดวางเครื่องมือทดลองนั้นจำเป็นต้องมีการอ้างอิง ซึ่งได้ใช้เปลี่ยนนิ้อนเลเซอร์เป็นหลัก (Reference laser / Alignment laser) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดวางเลเซอร์คาวิตี้ และอุปกรณ์ทางแสงอื่นๆ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งนี้การจัดวางโดยเนพะกระจาก M_1 และ M_2 นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตำแหน่งและ การวางตัวอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อการเกิดแสงเลเซอร์ที่ให้พลังงานสูงสุด นอกจากนี้ได้มีการวัดスペกตรัมของแสงเลเซอร์แบบ Free running เสปคตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์ที่ใช้ในการกระตุ้นก่อให้เกิดแสงเลเซอร์ ตลอดจนการวัดรอยไหม้ (Burnt Pattern) อันเนื่องมาจากการแสดงคิวสวิตท์เลเซอร์ พลังสูง

4.1 เครื่องมือวัดค่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

4.1.1 กระจกเคลือบพิเศษ ในการจัดเลเซอร์คาวิตี้นั้นจำเป็นต้องมีกระจกเคลือบด้วยสารไดอะลีกตริกแบบพิเศษ (หนาประมาณ 20 ชั้น) เพื่อทำการเบิดหัวและท้ายของเลเซอร์คาวิตี้ในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ใช้กระจก M_1 มีค่าสะท้อนกลับ (Reflectivity) 100% ที่ $\lambda = 1064 \text{ nm}$ และกระจก M_2 มีค่าสะท้อนกลับ 80% ที่ $\lambda = 1064 \text{ nm}$ และกระจกทั้งสองมีค่ารัศมีความโค้ง $r_1 = r_2 = 5000$ มิลลิเมตร โดยก้านด้านหลัง M_2 เป็นกระจกที่แสงเลเซอร์ส่องผ่านออกมานอก (Output mirror)

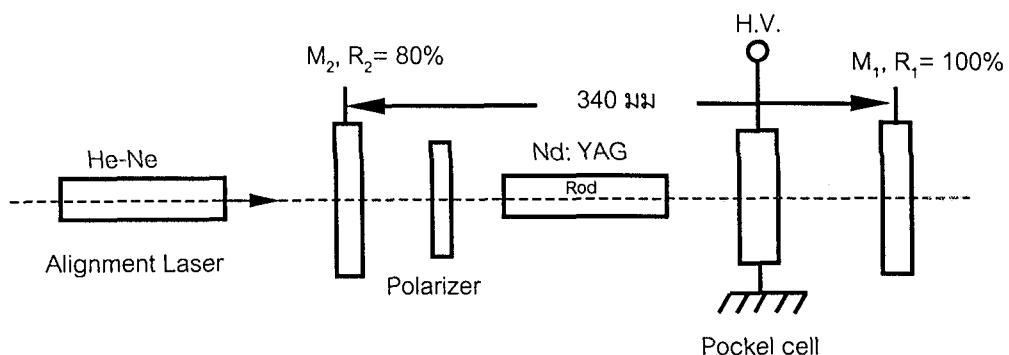
4.1.2 เครื่องวัดพลังงาน (Energy meter) เครื่องมือวัดพลังงานที่ใช้ในการทดลองผลิตโดยบริษัท Gentech serial no. ED 200 สามารถวัดค่าพลังงานได้ตั้งแต่ 10^{-6} J ถึง 10 Joules เครื่องมือนี้จะใช้หลักการในการเปลี่ยนพลังงาน อินฟราเรดของแสงเลเซอร์แล้วเปลี่ยนเป็นศักดิ์ไฟฟ้า อ่านค่าอุณหภูมิเป็นมิลลิโวลต์ (millivolt) ซึ่งมี Conversion factor เป็น $1 \text{ millivolt (mV)} = 1.6 \text{ millijoule (mJ)}$

4.1.3 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) และเครื่องถ่ายภาพโพลารอยด์ ในการทดลองนี้ใช้เครื่อง Oscilloscope ของบริษัท Tektronix model no. 2465B และ model no. 7934 และ Plug in 7A24 และใช้ กล้องถ่ายภาพโพลารอยด์ของบริษัท Tektronix model CP 53 ฟิล์มโพลารอยด์ # 667 ในกรณีที่ ออสซิลโลสโคปเริ่มทำางานนั้นได้ใช้สัญญาณจากเครื่องจ่ายกำลัง (Power supply) เป็นตัวกระตุ้นการทำางาน(Trigger) ให้กับออสซิลโลสโคป

4.1.4 โฟโตไดโอด (Photodiode) ในการทดลองนี้ได้ใช้โฟโตไดโอด ของบริษัท Hewlette Packard no. HP 4220 เป็นตัววัดスペกตรัมของแสงที่ ออกมาจากแฟลชแอลมพ์ ซึ่งมีธรรมชาติเป็นแอบกว้าง (Broad Band) จะมีแสงที่คล้ายความยาวคลื่นวิ่งออกมากเพื่อทำการกระตุ้นแท่ง Nd: YAG

4.2 การจัดวางระบบคิวสวิตท์เลเซอร์

ในการทำ ทำให้เกิดคิวสวิตท์เลเซอร์ของการทดลองนี้ได้มีการใช้ Pockel Cell เป็นเครื่องมือในการควบคุมและทำ ทำให้เกิดคิวสวิตท์พัลส์ หลักการทำ ทำให้เกิดคิวสวิตท์พัลส์ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 (รูปที่ 2.11) แล้ว ดังนั้น จำเป็นต้องมีชีลีบันนี่อนเลเซอร์ซึ่งเป็น Alignment เลเซอร์เพื่อช่วยในการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นระบบคิวสวิตท์เลเซอร์และให้พัลส์ที่มีกำลังมากที่สุด การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวดังนี้ได้แสดงไว้ในรูป 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงการจัดวางระบบคิวสวิตท์เลเซอร์โดยมี Pockel cell

เริ่มต้นให้วางตำแหน่งหัวเลเซอร์ให้เหมาะสมโดยให้แสงของชีลีบันนี่อนเลเซอร์ผ่านแท่ง Nd: YAG ก่อนจากนั้นก็ให้วางตำแหน่งกระจะ

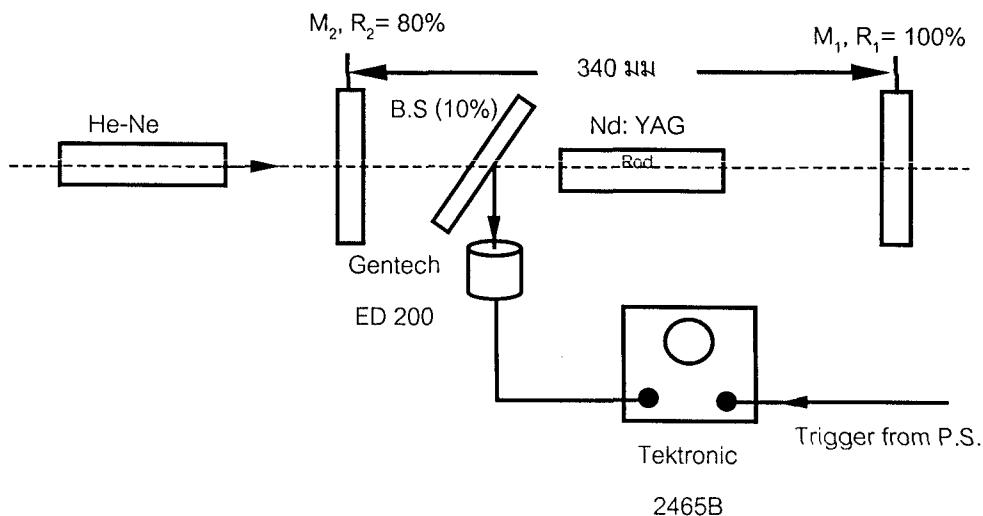
M_1 ต่อมาวาง Pockel Cell Polarizer และกระจก M_2 สูดท้าย ทั้งนี้ให้ขัดวงตัวแทนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้แกนตั้งฉากกับผิวอุปกรณ์นั้นอยู่ในแนวตัวแสงของอีเลิมโน่อนเลเซอร์

เมื่อขัดวงตัวแทนของอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ให้ทดลองยิงเลเซอร์และดูว่าจะให้กำลังสูงดีพอไหม โดยทำการปรับระยะของตัวแทนกระจก M_1 และ M_2 จนกระทั่งได้ค่ากำลังของแสงเลเซอร์ที่ต้องการสูด

4.3 การวัดพลังงานของแสงเลเซอร์ที่ต้องการ

เมื่อปรับการวางแผนตัวของกระจก M_1 และ M_2 ที่ทำให้แสงเลเซอร์ที่ต้องการมีกำลังได้สูงสุดแล้ว การวัดการแปรตามของกำลังแสงเลเซอร์ที่ต้องการ เมื่อมีการเพิ่มศักดิ์ให้แก่ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ของเครื่องจ่ายกำลังตามที่ทราบคือว่า จำนวนประจุ Q แปรตามศักดิ์ที่ให้กับตัวเก็บประจุ ($Q = CV$) เมื่อ C เป็นค่าของการเก็บประจุ

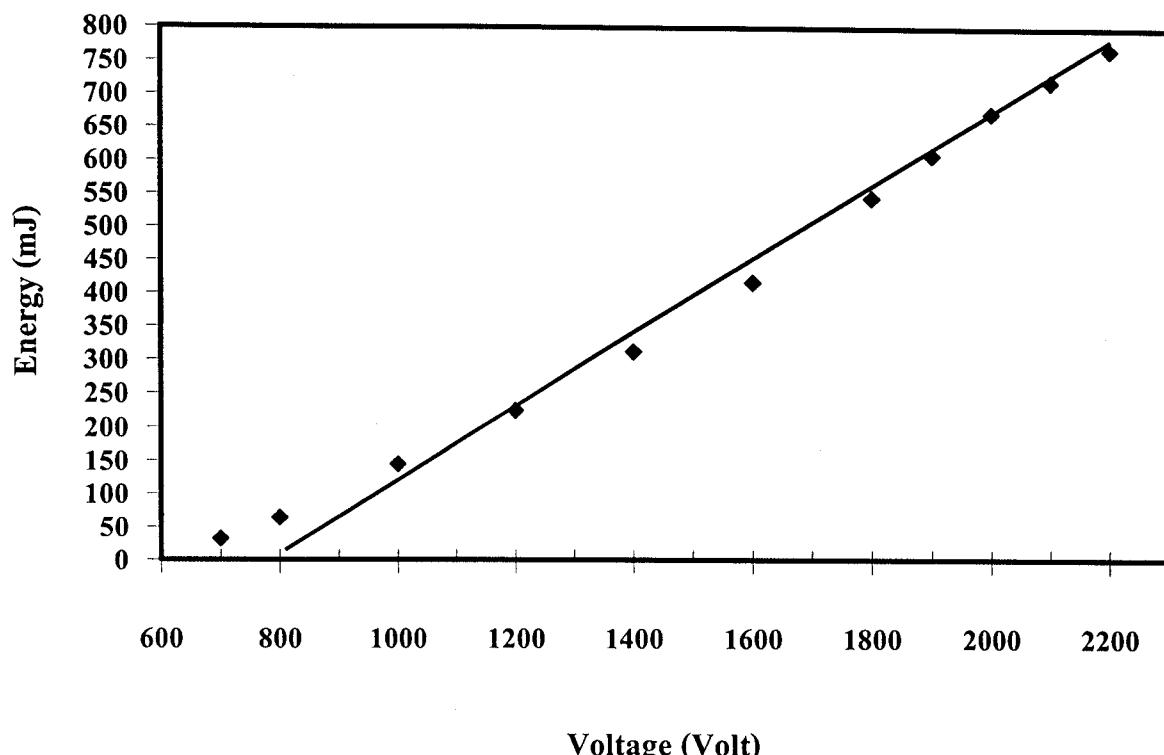
ในการวัดพลังงานของแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมามีช่วงๆ (Pulse) นั้น ได้มีการใช้เครื่องวัดกำลัง Gentech ED 200 วางอยู่ภายในเลเซอร์คาวิตี้ ใน



รูปที่ 4.2 แสดงการจัดการเครื่องมือในการวัดพลังงาน (Energy) ของระบบเลเซอร์ ที่ต้องการ มาจากแท่งผลึก Nd:YAG

ด้านที่ติดกับกระจก M_2 (Output mirror) ในการนี้ได้ใช้กระจกไสลด์ (Beam splitter; B. S) วางอยู่ระหว่างกระจก M_2 และ หัวเลเซอร์ดังในรูปที่ 4.2 กระจกไสลด์ (B.S) นี้จะแบ่งแสงเลเซอร์ที่เกิดขึ้น 10% เข้าสู่เครื่องวัดกำลัง

Gentech ED 200 และมีสาย Coaxial ต่อมาข้างօอสซิลโลสโคป Tektronix 2465B ในกรณีนี้ได้ใช้สัญญาณของการจุดแฟลชแลมพ์จากเครื่องจ่ายกำลังมาเป็นสัญญาณให้เครื่องօอสซิลโลสโคปทำงาน (Trigger) ทั้งนี้เพื่อจะได้วัดกำลังของแสงเลเซอร์ทั้งที่มีแฟลชแลมพ์กระตุ้นแท้จริง Nd:YAG ให้เกิดแสงเลเซอร์ออกมานานาแปร (Linear) ทั้งนี้เพื่อระดับการวัดค่าพลังงาน



รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ของกำลังเลเซอร์ (Laser power output) กับศักดาไฟฟ้าของเครื่องจ่ายกำลัง

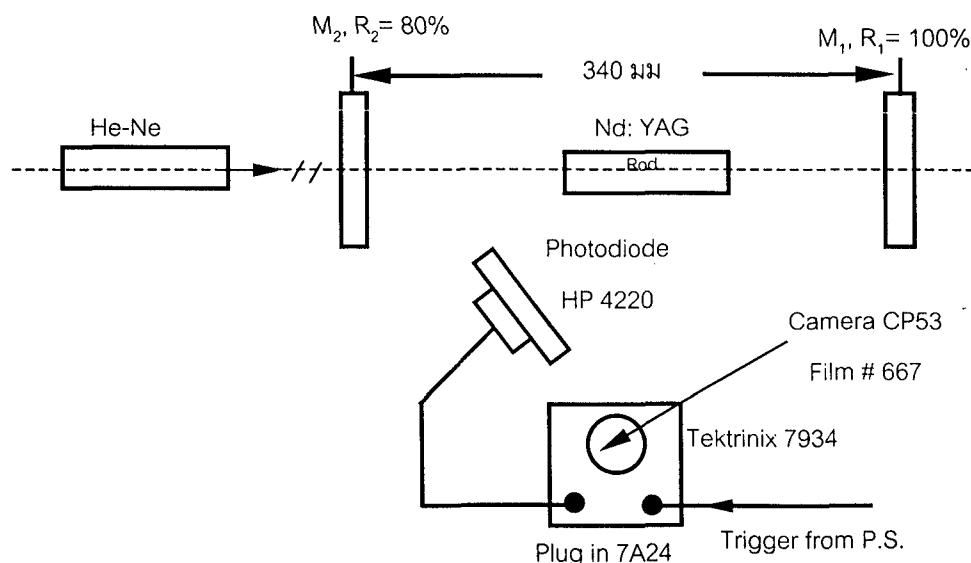
ของแสงเลเซอร์ที่ออกมานา (Output) โดยทำการวัดกึ่งลังของแสงเลเซอร์ที่ออกมานาจากการเปลี่ยนค่าศักดาไฟฟ้าของเครื่องจ่ายกำลัง (รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1 ของภาคผนวก ก) พบว่าเลเซอร์ให้กึ่งลังสูงสุดเท่ากับ 768 mJ ที่เครื่องจ่ายกำลังทำงานที่ศักดาไฟฟ้า 2200 โวลต์ ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเลเซอร์ที่ส่งออกมานาและศักดาไฟฟ้าໄດ້แสดงไว้ในรูปที่ 4.3 จะสังเกตเห็นได้ว่าที่ ศักดาน้อยกว่า 1000 โวลต์ จุดข้อมูลจะไม่อยู่ในเส้นเริ่มจะ

ที่ งานเพราะบางครั้งยังเลเซอร์แล้วออกบ้าง ไม่ออกบ้างดังนั้นเส้นตรงที่แสดงในรูปที่ 4.3 จะเป็นกราฟที่เฉลี่ยแล้ว

4.4 การวัดสเปกตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์

ในการวัดสเปกตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์นั้นเรานำไฟโตไคโอดที่มีขีดความสามารถในการวัดสเปกตรัมแบบแบนกว้าง (Broadband spectrum) ทั้งนี้หลอดแฟลชแอลมพ์ที่ให้แสงออกมานั้นให้แสงออกมากถายความถี่ (หรือช่วงคลื่น) ต่อเนื่องออกมา ไฟโตไคโอดที่ใช้คือ HP 4220 การจัดวางระบบเลเซอร์และไฟโตไคโอดได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.4

ไฟโตไคโอด HP 4220 ได้ต่อเข้าออสซิลโลสโคป Tektronix 7934 โดยใช้ Plug in no. 7A24 และมีสัญญาณ Trigger ส่งมาจากเครื่องจ่ายกำลังภาพของสเปกตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์ ได้บันทึกเป็นภาพโดยกล้อง CP53 พลัม โพลารอยค์เบอร์ 667 ภาพนี้แสดงไว้ในรูปที่ 4.5



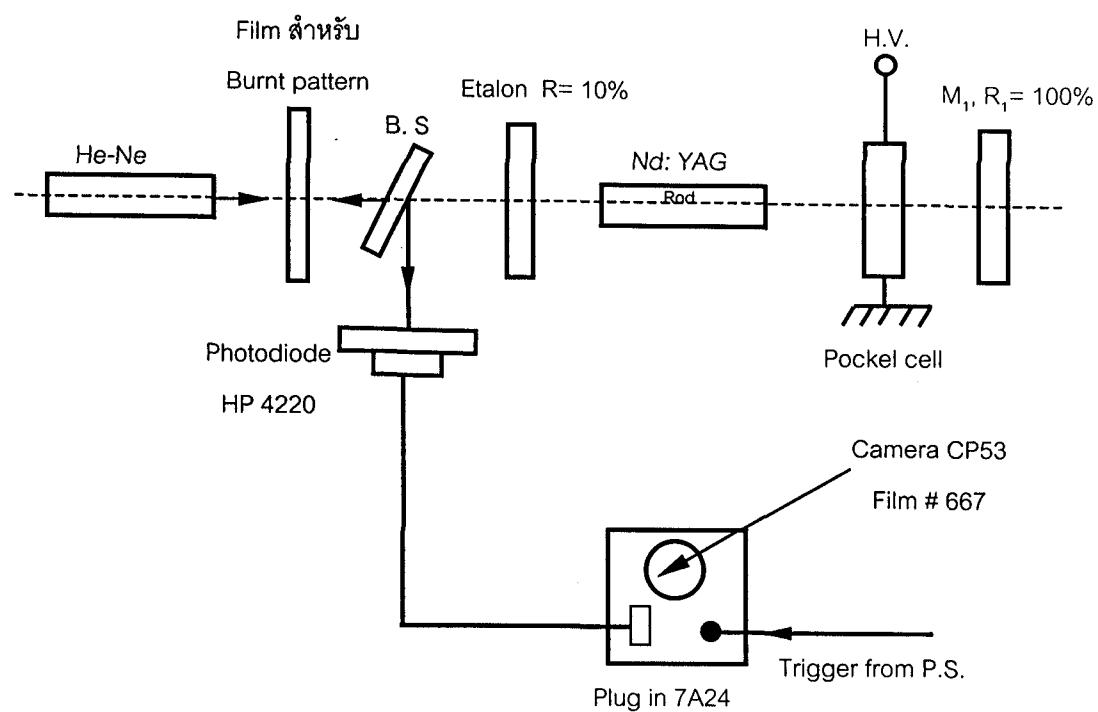
รูปที่ 4.4 แสดงการจัดวางเครื่องมือเพื่อการวัดสเปกตรัมของแสงแฟลชแอลมพ์

รูปที่ 4.5 แสดงสเปกตรัมของแสงแฟลชแลมพ์

4.5 รอยเพาไหม์ (Burnt Pattern) ของแสงเลเซอร์

ในการทดลองดูร่องไฟมีบนกระจกที่รอรับแสงเลเซอร์ นั้นได้มีการจัดวางระบบเลเซอร์ตามที่แสดงในรูปที่ 4.6 ในการวัดระบบนี้เราได้ใช้ Etalon ที่มี Reflectivity 10 % (แทนตำแหน่งกระจาก M_2 (Output minor) และวางตำแหน่ง Beam Splitter (BS) ดาวติดโดยให้แสงบางส่วนจาก BS. พุ่งสู่ไฟโตไดโอด HP 4220 ซึ่งต่อไปยังอสซิลโลสโคป ซึ่งมีกล้องโพลารอยด์ติดอยู่ด้วย นอกจากนี้ได้จัดวางกระจก ซึ่งเป็นโพลารอยด์ฟิล์ม เพื่อให้แสงเลเซอร์ตกกระหบและเพาไหม์ จากการทดลองพบว่ารอยเพาไหม์ (Burnt pattern) บนแผ่นฟิล์มเป็นวงกลมมีขนาดเท่าๆ กันและสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยเพาไหม์มีค่า $\phi = 5 \text{ nm}$. รูปอย่างเพาไหม์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.7

การวัดรอยเพาไหม์ บนแผ่นฟิล์มนี้เป็นการทดสอบวิธีหนึ่งของการเกิดแสงเลเซอร์แบบคิวสวิตท์เพราเจก์ လังงานทั้งหมดแทนที่จะกระจายออกแบบแสงเลเซอร์ฟรีรันนิ่ง (Free running) ก็ လังงานเหล่านี้จะมารวมตัวในระยะเวลาอันสั้นประมาณ 20-30 ns. (Nano second) และอยู่ในบริเวณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง $\phi = 5 \text{ nm}$.



รูปที่ 4.6 แสดงการจัดวางเครื่องมือเพื่อการถ่ายภาพ Laser spikes และการดูรอยเพาไหน์ (Burnt pattern)

รูปที่ 4.7 แสดงรอยเพาไหน์ (Burnt Pattern) ของแสงเดซอร์บนโพลารอยด์ฟิล์ม

เนื่องจากเครื่องจ่ายกำลัง (Power supply) ทำด้วยอุปกรณ์แบบธรรมชาติโดยมีค่า Inductance มาก ดังนั้นในการวัดเสปคตรัมของแสงเลเซอร์แบบคิวสวิตท์ ซึ่งที่ช่วงกว้างของพัลส์ แคนบมาก (ประมาณ 20-30 ns.) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ออสซิลโลสโคปที่มีความไวและละเอียดอ่อน ซึ่งที่ถูกรบกวนด้วย noise ที่เกิดจากวงจรของเครื่องจ่ายกำลัง ดังนั้นในการทดลองจึงไม่สามารถถ่ายภาพคิวสวิตท์พัลส์ของเลเซอร์ได้

จากการคำนวณ (ภาคผนวก ข) พบว่าแสงเลเซอร์มีกำลังงาน (Power) $P = 256 \text{ MW}$. ซึ่งเป็นกำลังงานในระดับทั่วไปของคิวสวิตท์เลเซอร์ อายุรุ่งไว้ตามกำลังงานนี้จะเกิดในช่วงเวลา 30 ns. เท่านั้น

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาระบบคิวสวิตท์เลเซอร์นี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุภายในประเทศ เป็นหลัก ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบคิวสวิตท์เลเซอร์ที่มีขนาดกระหัตครัค และผลที่ได้ออกมาสามารถผลิตแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานที่ก้าหนดไว้โดยประมาณ คือ มีขนาดประมาณ 600 มิลลิจูล (mJ) ผลการวิจัยนี้ได้แสดงออกและยืนยันขึ้นว่าความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สามารถผลิตระบบ เลเซอร์แข็ง (Solid State Laser System) ได้สำเร็จในระดับคิวสวิตท์เลเซอร์ ที่มีความกว้างของพลัสประมาณ 10^{-9} วินาที ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการทดลอง และขาดเครื่องมืออุปกรณ์วัดที่ทันสมัย

การวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการผลิตแสงเลเซอร์แบบของแข็งโดยใช้ฟลีก Nd: YAG ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง $\varnothing = 6$ มม. และยาว 75 มม. โดยมีรังสีที่ปีกหัวและท้ายของเลเซอร์คาวิตีเป็น $M_1 (R_1 = 100\%)$ และ $M_2 (R_2 = 80\%)$ และความยาวของคาวิตี $L = 340$ มม. ให้พลังงานสูงสุด $P_{max} = 768$ mJ ปริมาณของพลังงานที่ระบบเลเซอร์นี้ผลิตได้นี้ สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมแบบ Spot welding บริเวณเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ปริมาณของพลังงานสำหรับ spot welding จุดเด็กที่ต้องการใช้มีเพียง $P \cong 100$ mJ

ในการที่ทำการวิจัยและพัฒนาระบบคิวสวิตท์เลเซอร์นี้ หากท่านต้องไปในอนาคตนั้นควรจะต้องออกแบบเครื่องมือจ่ายกำลัง (Power supply) ใหม่ โดยจะต้องระวังเรื่องการส่งสัญญาณจากเครื่องจ่ายกำลังออกแบบควบคุม ทำการบิงแส้งเลเซอร์ เพราะจะทำให้การใช้เครื่องออกซิลิโอลีตโค่มีปัญหาในการตรวจวัด อายุการ์ตตาม ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ จะเป็นพื้นฐานให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาระบบเลเซอร์แข็ง (Solid State Laser System) ต่อไป

បររលាយក្រម

បររបាណក្រសួង

- Bloembergen, N., Pershan, P.S.(1964). Light waves at The booundary of nonlinear media.
Phys.Rev. 128 : 606.
- Boyd, G.D., and Gordon, J.P (1961). Confocal Multimode Resonator Millimeter through Optic
 Wavelength Masers, **Bell System Technical Journal**, 40, 489.
- Einstein, A. (1917). Zur Quantentheorie der Strahlung, **Physic Z**, 18, 21.
- Gordon, J.P., Zeiger, H., and Townes, C.H. (1954). Molecular Microwave Oscillator and New
 Hyperfine Structure in the Microwave Spectrum of NH_3 . **Phys.Rev.**, 95,282.
- Geusic, J.E., Macos, H.M., and Van Uitert, L.G. (1964). Laser Oscillator in Nd-doped Yttrium
 Aluminium, Yttrium Gallium and Gadolinium Garnets, **Appl. Phys. Lett**, 4, 182
- Hellwarth, R.W.(1961). **Advances in Quantum Electronics**. Colembia University Press :
 New York.
- Hellwarth, R.W.(1966). **Q-Moderation of Laser**. Marcel Dekker : New York.
- Koechner, W. (1976). **Solid State Laser Engineering**. Springer Verlag, New York.
- Maimann, T.H.(1960). Stimulated optical Radiation in reby. **Nature**. 187 : 493.
- Robinson, A.L. (1984). Soft X-ray Lasder at Lawrence Livermore Laboratory, **Science**, 226, 821.
- Schalow, A.L. and Townes, C.H.(1958). Infrared And optical Maser. **Phys. Rev.** 112 : 1940
- Yariv, A.(1989). **Quantum Electronics**. John Wiley and Sons : Singapore

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางที่ 1 ข้อมูลการวัดค่าพลังงานของเลเซอร์

Energy meter : Gentech ED 200

Conversion 1mV = 0.16 mJ

Variac (volts)	Gentech (mV)	Energy (mJ)
700	200	32
800	400	64
1000	900	144
1200	1400	224
1400	1900	312
1600	2600	416
1800	3400	544
1900	3800	608
2000	4200	672
2100	4500	720
2200	4800	768

ภาคผนวก ข

การคำนวณหากำลังงาน

จากตารางที่ 1. เรายกนว่า พลังงานสูงสุดที่ระบบเลเซอร์ให้ในขณะที่เป็น Free running เมื่อเครื่องจ่ายกำลังที่ งานที่สักค่า 2200 โวลต์ มีค่าเป็น 768 mJ ในสภาพทั่วไป คิวสวิตท์พัลส์จะมีความยาว $t = 30 \times 10^{-9}$ sec

$$\text{ดังนั้น กำลัง } P = \frac{\text{พลังงาน}}{\text{เวลา}}$$

$$P = \frac{768 \times 10^{-3} J}{30 \times 10^{-9} \text{ sec}} = 2.56 \times 10^8 = 256 MW$$

จาก Burnt Pattern เรายกนว่า เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของ Burnt Pattern มีค่าประมาณเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่ง Nd:YAG ดังนั้น $D = 0.5\text{cm}$ กำหนดให้ A เป็นค่าพื้นที่ของ Burnt Pattern เราจะได้

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{1}{4} \times 3.14 \times (0.5)^2 = 0.1963 \cong 0.2 cm^2$$

$$\text{กำหนดให้ ความหนาแน่นของกำลังต่อพื้นที่} = P/A \text{ เราจะได้}$$

$$\begin{aligned} P/A &= \frac{256 MW}{0.2 cm^2} = 1.28 \times 10^3 MW/cm^2 \\ &= 1.28 GW/cm^2 \end{aligned}$$

ค่า P และ P/A ที่ได้นี้คุณจะเป็นปริมาณที่มากแต่ก็เป็นค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก ค่าที่ได้นี้เป็นค่าที่ได้ใน Order of magnitude ของ คิวสวิตท์เลเซอร์ที่ให้กำลังงาน นำไปใช้งานทางศึกษา Nonlinear Optics ซึ่ง กระตุ้นให้เกิดแสงเชิงกันสาร ในนิคหรือปรากฏการณ์ทางอนติเนียร์ออฟ ติกอื่นๆ ทดสอบการตัด เช่น ไออกะหรือสารกึ่งตัวนำ ได้เป็นอย่างดี

ประวัติผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ พันธุ์วนวิน เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ได้รับทุนรัฐบาลไทย (ก.พ./คุรสภ) ไปศึกษาสาขาฟิสิกส์ ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2503 สำเร็จปริญญาตรี (ฟิสิกส์) จาก University of California, Berkeley ปี พ.ศ. 2507 ปริญญาโท (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) จาก University of Illinois, Urbana ปี พ.ศ. 2509 ได้เก็บบันทึกการท่องเที่ยวที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส ต่อมาได้โอนข้ามไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีส่วนร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ปี พ.ศ. 2513 ได้รับทุน USAID ไปศึกษาดอร์ระดับปริญญาเอกด้านเดเซอร์ ที่ University of Maryland, College Park เรียนจบปริญญาเอก เมื่อ พ.ศ. 2516 ระหว่างที่ทำการศึกษา ณ. ประเทศไทย ได้รับทุนจาก University of Illinois, Urbana เป็น Research Assistant ประจำ Cyclotron Nuclear Radiation Laboratory และทุน Research Assistant ประจำ Solid State Laser Laboratory ของ University of Maryland, College Park

ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ พันธุ์วนวิน ได้มีส่วนร่วมก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักวิชาชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีผลงานในการตั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดจนติดตั้งห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ในหลายมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้ง School of Laser Technology and Photonics เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา และได้ตั้งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาค ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2541 ได้ทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาเดเซอร์ แสง และพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) ติดพิมพ์ในประเทศไทยและต่างประเทศประมาณ 30 เรื่อง ได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านวิชาการพอสรุปได้คือ

- รางวัลที่ 3 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบชีเดย์น-นีออนเดเซอร์จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2526
- รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบแฟลชแลนพ์พันพุ่ม เทคนิคด้วยเดเซอร์จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2543

- The First Sawar Razmi Prize ค้านการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางค้าน Laser และ Optics จาก International Center for Theoretical Physics (ICTP) UNESCO/IAEA, Trieste, Italy ค.ศ. 1991

คำรำคำแหงคณบดีคณแรกของสำนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา

ปัจจุบันคำรำคำแหงหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ที่อยู่ปัจจุบัน 26 ถนนเสรี หมู่บ้านเสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 02-
7190207 โทรสาร 02-3196875